

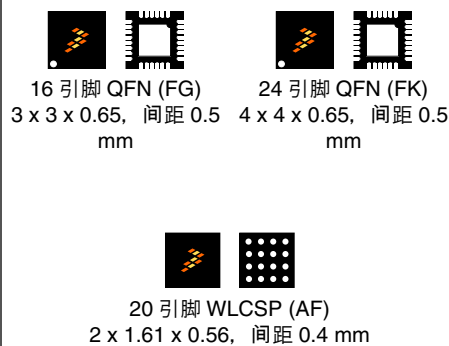
## Kinetis KL03 32 KB Flash

基于 48 MHz Cortex-M0+ 的微控制器

支持 Flash 高达 32 KB 的超低功耗 48 MHz 器件。  
基于 ARM® 技术的全球最小 MCU。物联网边缘节点设计的理想解决方案，具有超小规格和超低功耗。该产品具有以下特性：

- 微型封装，包括 1.6 x 2.0 mm<sup>2</sup> WLCSP
- 运行功耗低至 50  $\mu$ A/MHz
- 静态功耗低至 2.2  $\mu$ A，完整保持睡眠现场的唤醒时间为 7.5  $\mu$ s，深度睡眠时的最低静态模式电流低至 77 nA
- 高度集成的外设，包括全新 ROM 引导程序和高精度内部电压基准等

**MKL03ZxxVFG4**  
**MKL03ZxxVFK4**  
**MKL03Z32CAF4R**



### 内核

- ARM® Cortex®-M0+ 内核频率高达 48 MHz

- 温度范围（环境）：-40 至 105°C（QFN 封装）；-40 至 85°C（WLCSP 封装）

### 存储器

- 高达 32 KB 的程序 Flash 存储器
- 2 KB SRAM
- 8 KB ROM（具有内置引导加载程序）
- 16 字节 regfile

### 人机接口

- 通用输入/输出多达 22 个

### 系统外设

- 九种低功耗模式，可根据应用要求提供功耗优化
- COP 软件看门狗
- 低漏电唤醒单元
- SWD 调试接口和微跟踪缓冲器
- 位操作引擎

### 通信接口

- 一个 8 位 SPI 模块
- 一个 LPUART 模块
- 一个 I2C 模块（速度高达 1 Mbit/s），具有双缓冲

### 时钟

- 48 MHz 高精度内部参考时钟
- 8/2 MHz 低功率内部参考时钟
- 32 kHz 至 40 kHz 晶振
- 1 kHz LPO 时钟

### 模拟模块

- 12 位 SAR ADC，带内部电压基准，达 818 ksps 和 7 个通道
- 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的高速模拟比较器
- 1.2 V 电压基准(Vref)

### 工作特性

- 电压范围：1.71 V 至 3.6 V
- Flash 写入电压范围：1.71 V 至 3.6 V

### 定时器

- 两个双通道定时器/PWM 模块
- 一个低功耗定时器
- 实时时钟

### 安全性和完整性模块

- 每个芯片具有 80 位唯一标识号

### 订购信息 1

| 部件编号            | 存储器        |           | I/O 最大数量 |
|-----------------|------------|-----------|----------|
|                 | Flash (KB) | SRAM (KB) |          |
| MKL03Z8VFG4(R)  | 8          | 2         | 14       |
| MKL03Z16VFG4(R) | 16         | 2         | 14       |
| MKL03Z32VFG4(R) | 32         | 2         | 14       |
| MKL03Z32CAF4R   | 32         | 2         | 18       |
| MKL03Z8VFK4(R)  | 8          | 2         | 22       |
| MKL03Z16VFK4(R) | 16         | 2         | 22       |
| MKL03Z32VFK4(R) | 32         | 2         | 22       |

1. 若要确认当前可订购器件编号的供货状态，请前往 <http://www.freescale.com> 并使用此器件编号搜索。

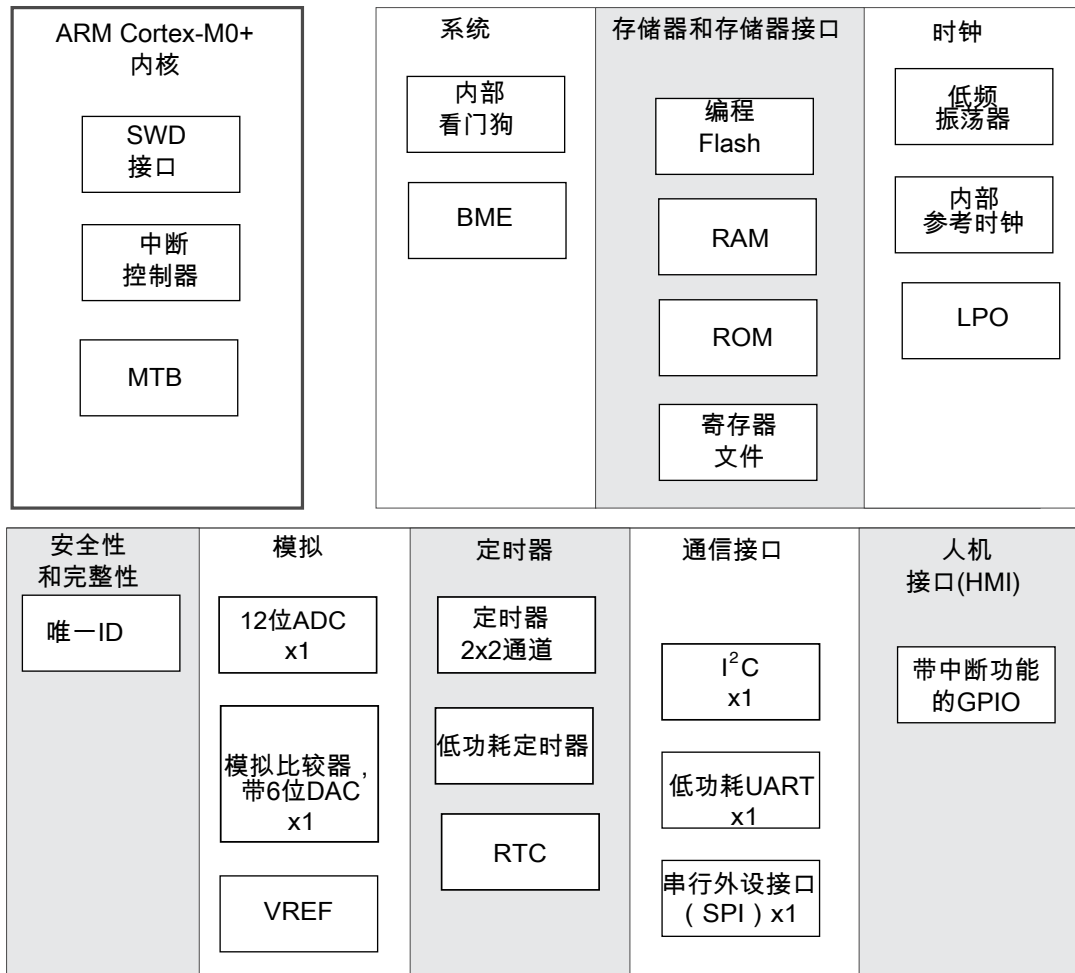
### 相关资源

| 类型    | 说明  | 资源   |
|-------|---|--|
| 选型指南  | Freescle Solution Advisor 是一款基于网络的工具，具有交互式应用向导和动态产品选型器。 | <a href="#">Solution Advisor</a>   |
| 产品简介  | 《产品简介》包含简洁的概述/总结信息，便于快速评估器件的设计适用性。                      | KL03PB <sup>1</sup>  |
| 参考手册  | 《参考手册》包含关于器件结构与功能（操作）的详细说明。                             | KL03P24M48SF0RM <sup>1</sup>   |
| 数据手册  | 《数据手册》包含电气特性和信号连接信息。                                    | KL03P24M48SF0 <sup>1</sup>   |
| 芯片勘误表 | 《芯片掩模组勘误表》提供特定器件掩模组的额外信息或更正信息。                          | KL03Z_1N86K <sup>1</sup>   |
| 封装图纸  | 封装图纸中提供了封装尺寸。   | QFN 16 引脚：98ASA00525D <sup>1</sup><br>QFN 24 引脚：98ASA00602D <sup>1</sup><br>WLCSP 20 引脚：98ASA00676D <sup>1</sup> |

1. 如需获取相关资源，请前往 <http://www.freescale.com> 并使用以下术语进行搜索。

图 1 显示了芯片中的功能模块。

## Kinetis KL03系列



**图 1. 功能结构框图**

# 目录

|                           |    |                                |    |
|---------------------------|----|--------------------------------|----|
| 1 极限.....                 | 5  | 3.6 模拟.....                    | 31 |
| 1.1 热操作极限.....            | 5  | 3.6.1 ADC 电气特性.....            | 31 |
| 1.2 湿度操作极限.....           | 5  | 3.6.2 CMP 和 6 位 DAC 的电气特性..... | 35 |
| 1.3 ESD 操作极限.....         | 5  | 3.6.3 电压基准电气特性.....            | 37 |
| 1.4 电压和电流操作极限.....        | 5  | 3.7 定时器.....                   | 38 |
| 2 通用.....                 | 6  | 3.8 通信接口.....                  | 38 |
| 2.1 交流电气特性.....           | 6  | 3.8.1 SPI 电气及时序特性.....         | 39 |
| 2.2 静态电气特性.....           | 6  | 3.8.2 内部集成电路接口(I2C)时序.....     | 43 |
| 2.2.1 电压和电流工作要求.....      | 6  | 3.8.3 UART.....                | 44 |
| 2.2.2 LVD 和 POR 工作要求..... | 7  | 4 尺寸.....                      | 44 |
| 2.2.3 电压和电流特性.....        | 8  | 4.1 获取封装尺寸.....                | 44 |
| 2.2.4 运行模式转换特性.....       | 9  | 5 引脚分配.....                    | 45 |
| 2.2.5 功耗特性.....           | 9  | 5.1 KL03 信号多路复用和引脚分配.....      | 45 |
| 2.2.6 EMC 电磁辐射特性.....     | 23 | 5.2 KL03 引脚分配.....             | 46 |
| 2.2.7 设计时需考虑电磁辐射.....     | 24 | 6 订购器件.....                    | 48 |
| 2.2.8 电容属性.....           | 24 | 6.1 确定有效的可订购器件.....            | 48 |
| 2.3 开关特性.....             | 24 | 7 部件标识.....                    | 48 |
| 2.3.1 器件时钟特性.....         | 24 | 7.1 说明.....                    | 48 |
| 2.3.2 一般开关规格.....         | 25 | 7.2 格式.....                    | 49 |
| 2.4 热学特性.....             | 25 | 7.3 字段.....                    | 49 |
| 2.4.1 热学操作要求.....         | 25 | 7.4 示例.....                    | 49 |
| 2.4.2 热属性.....            | 25 | 8 术语和准则.....                   | 50 |
| 3 外设工作要求与特性.....          | 26 | 8.1 定义: 操作要求.....              | 50 |
| 3.1 内核模块.....             | 26 | 8.2 定义: 特性.....                | 50 |
| 3.1.1 SWD 电气特性.....       | 26 | 8.3 定义: 属性.....                | 50 |
| 3.2 系统模块.....             | 28 | 8.4 定义: 极限.....                | 51 |
| 3.3 时钟模块.....             | 28 | 8.5 超出极限的后果.....               | 51 |
| 3.3.1 MCG-Lite 规格.....    | 28 | 8.6 极限与操作要求的关系.....            | 52 |
| 3.3.2 振荡器电气特性.....        | 29 | 8.7 极限和操作要求准则.....             | 52 |
| 3.4 存储器 and 存储器接口.....    | 29 | 8.8 定义: 典型值.....               | 52 |
| 3.4.1 Flash 电气特性.....     | 29 | 8.9 典型值条件.....                 | 53 |
| 3.5 安全性和完整性模块.....        | 31 | 9 修订记录.....                    | 54 |

# 1 极限

## 1.1 热操作极限

表 1. 热操作极限

| 符号               | 说明     | 最小值 | 最大值 | 单位 | 注释 |
|------------------|--------|-----|-----|----|----|
| T <sub>STG</sub> | 存储温度   | -55 | 150 | °C | 1  |
| T <sub>SDR</sub> | 无铅焊接温度 | —   | 260 | °C | 2  |

1. 根据 JEDEC 标准 JESD22-A103“高温存储时间”确定。
2. 根据 IPC/JEDEC 标准 J-STD-020“非密封固态表面安装器件的潮湿/回流敏感度分级”确定。

## 1.2 湿度操作极限

表 2. 湿度操作极限

| 符号  | 说明      | 最小值 | 最大值 | 单位 | 注释 |
|-----|---------|-----|-----|----|----|
| MSL | 湿度灵敏度等级 | —   | 3   | —  | 1  |

1. 根据 IPC/JEDEC 标准 J-STD-020“非密封固态表面安装器件的潮湿/回流敏感度分级”确定。

## 1.3 ESD 操作极限

表 3. ESD 操作极限

| 符号               | 说明                | 最小值   | 最大值   | 单位 | 注释 |
|------------------|-------------------|-------|-------|----|----|
| V <sub>HBM</sub> | 静电放电电压, 人体放电模式    | -2000 | +2000 | V  | 1  |
| V <sub>CDM</sub> | 静电放电电压, 设备充电模式    | -500  | +500  | V  | 2  |
| I <sub>LAT</sub> | 105 °C 环境温度下的门锁电流 | -100  | +100  | mA | 3  |

1. 根据 JEDEC 标准 JESD22-A114“静电放电(ESD)灵敏度测试人体放电模式(HBM)标准”确定。
2. 根据 JEDEC 标准 JESD22-C101“微电子组件静电放电耐压阈值的电场感应器件充电模式测试方法”确定。
3. 根据 JEDEC 标准 JESD78“IC 门锁测试”确定。

## 1.4 电压和电流操作极限

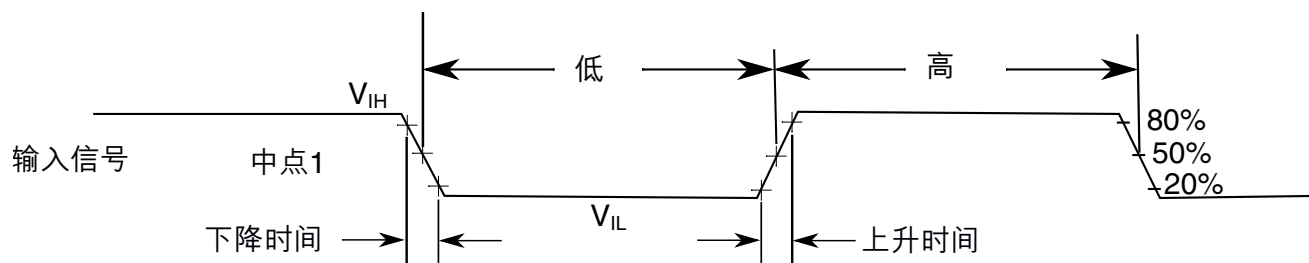
表 4. 电压和电流操作极限

| 符号        | 说明                      | 最小值            | 最大值            | 单位 |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|----|
| $V_{DD}$  | 数字供电电压                  | -0.3           | 3.8            | V  |
| $I_{DD}$  | 数字供电电流                  | —              | 120            | mA |
| $V_{IO}$  | IO 引脚输入电压               | -0.3           | $V_{DD} + 0.3$ | V  |
| $I_D$     | 单引脚瞬态最大电流限值 (适用于所有端口引脚) | -25            | 25             | mA |
| $V_{DDA}$ | 模拟供电电压                  | $V_{DD} - 0.3$ | $V_{DD} + 0.3$ | V  |

## 2 通用

### 2.1 交流电气特性

除非另有说明, 否则传播延迟在 50%到 50%点处测得, 上升时间和下降时间在 20%和 80%点处测得, 如下图所示。



中点是  $V_{IL} + (V_{IH} - V_{IL}) / 2$

图 2. 输入信号测量参考

除非另有说明, 否则所有数字 I/O 开关特性均假设输出引脚具备下列特性。

- $C_L=30$  pF 负载
- 压摆率禁用
- 正常驱动强度

### 2.2 静态电气特性

## 2.2.1 电压和电流工作要求

表 5. 电压和电流工作要求

| 符号                 | 说明  | 最小值   | 最大值   | 单位     | 注释 |
|--------------------|---|---|---|--------|----|
| $V_{DD}$           | 供电电压  | 1.71  | 3.6   | V      | —  |
| $V_{DDA}$          | 模拟供电电压  | 1.71  | 3.6   | V      | —  |
| $V_{DD} - V_{DDA}$ | $V_{DD}$ 至 $V_{DDA}$ 差分电压   | -0.1  | 0.1   | V      | —  |
| $V_{SS} - V_{SSA}$ | $V_{SS}$ 至 $V_{SSA}$ 差分电压   | -0.1  | 0.1   | V      | —  |
| $V_{IH}$           | 输入高电压<br><ul style="list-style-type: none"> <li><math>2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 3.6\text{ V}</math></li> <li><math>1.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 2.7\text{ V}</math></li> </ul> | $0.7 \times V_{DD}$<br>$0.75 \times V_{DD}$ | —<br>—                                      | V<br>V | —  |
| $V_{IL}$           | 输入低电压<br><ul style="list-style-type: none"> <li><math>2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 3.6\text{ V}</math></li> <li><math>1.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 2.7\text{ V}</math></li> </ul> | —<br>—                                      | $0.35 \times V_{DD}$<br>$0.3 \times V_{DD}$ | V<br>V | —  |
| $V_{HYS}$          | 输入迟滞  | $0.06 \times V_{DD}$                        | —   | V      | —  |
| $I_{ICIO}$         | IO 引脚负 DC 注入电流—单引脚<br><ul style="list-style-type: none"> <li><math>V_{IN} &lt; V_{SS}-0.3\text{V}</math></li> </ul>   | -5  | —   | mA     | 1  |
| $I_{ICcont}$       | 连续引脚 DC 注入电流 — 区域限制, 包括 16 个连续引脚的负注入电流之和<br><ul style="list-style-type: none"> <li>负电流注入</li> </ul>   | -25   | —   | mA     | —  |
| $V_{RAM}$          | 保持 RAM 数据所需的 $V_{DD}$ 电压  | 1.2   | —   | V      | —  |

1. 所有 I/O 引脚均通过 ESD 保护二极管内部钳位至  $V_{SS}$ 。  $V_{DD}$  未连接二极管。如果观察到  $V_{IN}$  大于  $V_{IO\_MIN}$  ( $= V_{SS}-0.3\text{ V}$ ) , 则无需在管脚上提供限流电阻。如果未观察到该限制, 则需要一个限流电阻。负 DC 注入限流电阻的计算公式如下:  $R = (V_{IO\_MIN} - V_{IN})/|I_{ICIO}|$ 。

## 2.2.2 LVD 和 POR 工作要求

表 6.  $V_{DD}$  电源 LVD 和 POR 工作要求

| 符号          | 说明   | 最小值  | 典型值      | 最大值  | 单位 | 注释 |
|-------------|--|------|----------|------|----|----|
| $V_{POR}$   | 下降沿电压 $V_{DD}$ POR 检测电压  | 0.8  | 1.1      | 1.5  | V  | —  |
| $V_{LVDH}$  | 下降沿低压检测阈值 — 高范围(LVDV = 01)   | 2.48 | 2.56     | 2.64 | V  | —  |
| $V_{LVW1H}$ | 低压警告阈值 — 高范围<br><ul style="list-style-type: none"> <li>1 级压降(LVWV = 00)</li> </ul> | 2.62 | 2.70     | 2.78 | V  | 1  |
| $V_{LVW2H}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 级压降(LVWV=01)</li> </ul>                   | 2.72 | 2.80     | 2.88 | V  | —  |
| $V_{LVW3H}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 级压降(LVWV=10)</li> </ul>                   | 2.82 | 2.90     | 2.98 | V  | —  |
| $V_{LVW4H}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 级压降(LVWV=11)</li> </ul>                   | 2.92 | 3.00     | 3.08 | V  | —  |
| $V_{HYSH}$  | 低压抑制复位/恢复迟滞 — 高范围  | —    | $\pm 60$ | —    | mV | —  |

下一页继续介绍此表...

表 6.  $V_{DD}$  电源 LVD 和 POR 工作要求 (继续)

| 符号          | 说明                                 | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 单位 | 注释 |
|-------------|------------------------------------|------|------|------|----|----|
| $V_{LVDL}$  | 下降沿低压检测阈值 — 低范围(LVDV=00)           | 1.54 | 1.60 | 1.66 | V  | —  |
| $V_{LVW1L}$ | 低压警告阈值 — 低范围<br>• 1 级压降(LVWV = 00) | 1.74 | 1.80 | 1.86 | V  | 1  |
| $V_{LVW2L}$ | • 2 级压降(LVWV=01)                   | 1.84 | 1.90 | 1.96 | V  |    |
| $V_{LVW3L}$ | • 3 级压降(LVWV=10)                   | 1.94 | 2.00 | 2.06 | V  |    |
| $V_{LVW4L}$ | • 4 级压降(LVWV=11)                   | 2.04 | 2.10 | 2.16 | V  |    |
| $V_{HYSL}$  | 低压抑制复位/恢复迟滞 — 低范围                  | —    | ±40  | —    | mV | —  |
| $V_{BG}$    | 带隙电压参考                             | 0.97 | 1.00 | 1.03 | V  | —  |
| $t_{LPO}$   | 内部低功耗振荡器周期 — 工厂调整                  | 900  | 1000 | 1100 | μs | —  |

1. 上升沿阈值 = 下降沿阈值 + 迟滞电压

## 2.2.3 电压和电流特性

表 7. 电压和电流特性

| 符号        | 说明   | 最小值            | 最大值   | 单位 | 注释   |
|-----------|--|----------------|-------|----|------|
| $V_{OH}$  | 输出高电压 — 正常驱动管脚 (reset_b 除外)<br>• $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 3.6\text{ V}$ , $I_{OH} = -5\text{ mA}$<br>• $1.71\text{ V} \leq V_{DD} \leq 2.7\text{ V}$ , $I_{OH} = -2.5\text{ mA}$ | $V_{DD} - 0.5$ | —     | V  | 1, 2 |
| $V_{OH}$  | 输出高压 — 高电平驱动管脚 (reset_b 除外)<br>• $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 3.6\text{ V}$ , $I_{OH} = -20\text{ mA}$<br>• $1.71\text{ V} \leq V_{DD} \leq 2.7\text{ V}$ , $I_{OH} = -10\text{ mA}$ | $V_{DD} - 0.5$ | —     | V  | 1, 2 |
| $I_{OHT}$ | 所有端口的总输出高电流  | —              | 100   | mA | —    |
| $V_{OL}$  | 输出低电压 — 正常驱动管脚<br>• $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 3.6\text{ V}$ , $I_{OL} = 5\text{ mA}$<br>• $1.71\text{ V} \leq V_{DD} \leq 2.7\text{ V}$ , $I_{OL} = 2.5\text{ mA}$                | —              | 0.5   | V  | 1    |
| $V_{OL}$  | 输出低电压 — 高电平驱动管脚<br>• $2.7\text{ V} \leq V_{DD} \leq 3.6\text{ V}$ , $I_{OL} = 20\text{ mA}$<br>• $1.71\text{ V} \leq V_{DD} \leq 2.7\text{ V}$ , $I_{OL} = 10\text{ mA}$               | —              | 0.5   | V  | 1    |
| $I_{OLT}$ | 所有端口的总输出低电流  | —              | 100   | mA | —    |
| $I_{IN}$  | 全温度范围的输入漏电流 (每个引脚)   | —              | 1     | μA | 3    |
| $I_{IN}$  | 25 °C 下的输入漏电流 (每个引脚)   | —              | 0.025 | μA | 3    |
| $I_{IN}$  | 全温度范围的输入漏电流 (所有引脚的总值)  | —              | 41    | μA | 3    |
| $I_{OZ}$  | Hi-Z (关闭状态) 漏电流 (每个引脚)   | —              | 1     | μA | —    |
| $R_{PU}$  | 内部上拉电阻   | 20             | 50    | kΩ | 4    |



1. I/O 同时具有高电平驱动和正常驱动能力，由相关的 PTx\_PCRn[DSE] 控制位进行选择。其他的 GPIO 只能进行正常驱动。
2. 配置为 reset\_b 信号或 GPIO 时，复位引脚仅含有下拉有效装置。配置为 GPIO 输出时，该引脚用作伪开漏输出。
3. 在  $V_{DD} = 3.6\text{ V}$  时测量
4. 在  $V_{DD}$  供电电压 =  $V_{DD}$  (最小值) 且  $V_{input} = V_{SS}$  时测量

## 2.2.4 运行模式转换特性

下表中，除  $t_{POR}$  和  $VLLSx \rightarrow RUN$  恢复时间外的所有规格均假定时钟配置如下：

- CPU 和系统时钟 = 48 MHz
- 总线和 Flash 时钟 = 24 MHz
- HIRC 时钟模式

$VLLSx \rightarrow RUN$  恢复采用 LIRC 时钟模式，默认 CPU 和系统频率为 8 MHz，总线和 Flash 时钟频率为 4 MHz。

表 8. 运行模式转换特性

| 符号        | 说明  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位            | 注释 |
|-----------|---|-----|-----|-----|---------------|----|
| $t_{POR}$ | POR 事件后，在芯片工作温度范围内，从 $V_{DD}$ 达到 1.8 V 到执行第一条指令所需的时间。 | —   | —   | 300 | $\mu\text{s}$ | 1  |
|           | • $VLLS0 \rightarrow RUN$                             | —   | 152 | 166 | $\mu\text{s}$ | —  |
|           | • $VLLS1 \rightarrow RUN$                             | —   | 152 | 166 | $\mu\text{s}$ | —  |
|           | • $VLLS3 \rightarrow RUN$                             | —   | 93  | 104 | $\mu\text{s}$ | —  |
|           | • $VLPS \rightarrow RUN$                              | —   | 7.5 | 8   | $\mu\text{s}$ | —  |
|           | • $STOP \rightarrow RUN$                              | —   | 7.5 | 8   | $\mu\text{s}$ | —  |

1. 正常引导(FTFA\_FOFT[LPBOOT]=11)。

## 2.2.5 功耗特性

表 9. KL03 QFN 封装功耗特性

| 符号        | 说明     | 最小值 | 典型值 | 最大值 <sup>1</sup> | 单位 | 注释 |
|-----------|--------|-----|-----|------------------|----|----|
| $I_{DDA}$ | 模拟供电电流 | —   | —   | 参见注释             | mA | 2  |

下一页继续介绍此表...

表 9. KL03 QFN 封装功耗特性 (继续)

| 符号                    | 说明   | 最小值    | 典型值          | 最大值 <sup>1</sup> | 单位 | 注释 |
|-----------------------|--|--------|--------------|------------------|----|----|
| I <sub>DD_RUNCO</sub> | 在计算操作模式下运行 Flash 中的 CoreMark - 48M HIRC 模式, 48 MHz 内核/ 24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul>            | —<br>— | 5.49<br>5.62 | 5.71<br>5.84     | mA | 3  |
| I <sub>DD_RUNCO</sub> | 在计算操作模式下运行 Flash 中的 While(1)循环 - 48M HIRC 模式, 48 MHz 内核/ 24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul>          | —<br>— | 5.16<br>5.27 | 5.37<br>5.48     | mA | 3  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 CoreMark, 所有外设时钟禁用, 48 MHz 内核/24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul>   | —<br>— | 6.03<br>6.16 | 6.27<br>6.41     | mA | 3  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 CoreMark, 所有外设时钟禁用, 24 MHz 内核/12 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul>   | —<br>— | 3.71<br>3.81 | 3.86<br>3.96     | mA | 3  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 CoreMark, 所有外设时钟禁用, 12 MHz 内核/6 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul>    | —<br>— | 2.47<br>2.58 | 2.57<br>2.68     | mA | 3  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 CoreMark, 所有外设时钟启用, 48 MHz 内核/24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul>   | —<br>— | 6.43<br>6.56 | 6.69<br>6.82     | mA | 3  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 48 MHz 内核/24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul> | —<br>— | 5.71<br>5.82 | 5.94<br>6.05     | mA | —  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 24 MHz 内核/12 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul> | —<br>— | 3.3<br>3.4   | 3.43<br>3.54     | mA | —  |

下一页继续介绍此表...

**表 9. KL03 QFN 封装功耗特性 (继续)**

| 符号               | 说明   | 最小值    | 典型值          | 最大值 <sup>1</sup> | 单位 | 注释 |
|------------------|--|--------|--------------|------------------|----|----|
| $I_{DD\_RUN}$    | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 12 MHz 内核/6 MHz Flash, $V_{DD} = 3.0\text{ V}$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> <li>105 °C 时</li> </ul>  | —<br>— | 2.28<br>2.38 | 2.37<br>2.48     | mA | —  |
| $I_{DD\_RUN}$    | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟启用, 48 MHz 内核/24 MHz Flash, $V_{DD} = 3.0\text{ V}$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> <li>105 °C 时</li> </ul> | —<br>— | 6.1<br>6.22  | 6.34<br>6.47     | mA | —  |
| $I_{DD\_RUN}$    | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 SRAM 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 48 MHz 内核/24 MHz Flash, $V_{DD} = 3.0\text{ V}$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> <li>105 °C 时</li> </ul>  | —<br>— | 3.14<br>3.27 | 3.23<br>3.36     | mA | —  |
| $I_{DD\_RUN}$    | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 SRAM 中的 While(1)循环, 所有外设时钟启用, 48 MHz 内核/24 MHz Flash, $V_{DD} = 3.0\text{ V}$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> <li>105 °C 时</li> </ul>  | —<br>— | 3.54<br>3.67 | 3.63<br>3.76     | mA | —  |
| $I_{DD\_VLPRCO}$ | 在计算操作模式下极低功耗运行 Flash 中的 While(1)循环 - 2 MHz LIRC 模式, 2 MHz 内核/0.5 MHz Flash, $V_{DD} = 3.0\text{ V}$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>                       | —      | 500          | 750              | μA | —  |
| $I_{DD\_VLPRCO}$ | 在计算操作模式下极低功耗运行 SRAM 中的 While(1)循环 - 8 MHz LIRC 模式, 4 MHz 内核/1 MHz Flash, $V_{DD} = 3.0\text{ V}$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>                          | —      | 188          | 217              | μA | —  |
| $I_{DD\_VLPRCO}$ | 在计算操作模式下极低功耗运行 SRAM 中的 While(1)循环 - 2 MHz LIRC 模式, 2 MHz 内核/0.5 MHz Flash, $V_{DD} = 3.0\text{ V}$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>                        | —      | 82           | 123              | μA | —  |
| $I_{DD\_VLPR}$   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 2 MHz 内核/0.5 MHz Flash, $V_{DD} = 3.0\text{ V}$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>                | —      | 503          | 754              | μA | —  |
| $I_{DD\_VLPR}$   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 125 kHz 内核/31.25 kHz Flash, $V_{DD} = 3.0\text{ V}$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>            | —      | 60           | 90               | μA | —  |
| $I_{DD\_VLPR}$   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟启用, 2 MHz 内核/0.5 MHz Flash, $V_{DD} = 3.0\text{ V}$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>                | —      | 516          | 774              | μA | —  |

下一页继续介绍此表...

表 9. KL03 QFN 封装功耗特性 (继续)

| 符号                     | 说明   | 最小值 | 典型值   | 最大值 <sup>1</sup> | 单位 | 注释 |
|------------------------|--|-----|-------|------------------|----|----|
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 8 MHz LIRC 模式, SRAM 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 4 MHz 内核/1 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br>• 25 °C 时       | —   | 209   | 350              | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 8 MHz LIRC 模式, SRAM 中的 While(1)循环, 所有外设时钟启用, 4 MHz 内核/1 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br>• 25 °C 时       | —   | 229   | 370              | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, SRAM 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 2 MHz 内核/ 0.5 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br>• 25 °C 时    | —   | 93    | 140              | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, SRAM 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 125 kHz 内核/31.25 kHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br>• 25 °C 时 | —   | 31    | 81               | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, SRAM 中的 While(1)循环, 所有外设时钟启用, 2 MHz 内核/ 0.5 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br>• 25 °C 时    | —   | 103   | 154              | μA | —  |
| I <sub>DD_WAIT</sub>   | 待机模式电流 - 内核禁用, 48 MHz 系统/24 MHz 总线, Flash 禁用 (Flash 休眠模式使能), 所有外设时钟禁用, MCG_Lite 处于 HIRC 模式, V <sub>DD</sub> = 3.0 V        | —   | 1.4   | 1.94             | mA | —  |
| I <sub>DD_WAIT</sub>   | 待机模式电流 - 内核禁用, 24 MHz 系统/12 MHz 总线, Flash 禁用 (Flash 休眠模式使能), 所有外设时钟禁用, MCG_Lite 处于 HIRC 模式, V <sub>DD</sub> = 3.0 V        | —   | 1.02  | 1.24             | mA | —  |
| I <sub>DD_VLPW</sub>   | 极低功耗待机模式电流, 内核禁用, 4 MHz 系统/ 1 MHz 总线和 Flash, 所有外设时钟禁用, V <sub>DD</sub> = 3.0 V   | —   | 121   | 181              | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPW</sub>   | 极低功耗待机模式电流, 内核禁用, 2 MHz 系统/0.5 MHz 总线和 Flash, 所有外设时钟禁用, V <sub>DD</sub> = 3.0 V  | —   | 59    | 97               | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPW</sub>   | 极低功耗待机模式电流, 内核禁用, 125 kHz 系统/31.25 kHz 总线和 Flash, 所有外设时钟禁用, V <sub>DD</sub> = 3.0 V  | —   | 28    | 42               | μA | —  |
| I <sub>DD_PSTOP2</sub> | 局部停止 2, 内核和系统时钟禁用, 12 MHz 总线和 Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V   | —   | 1.53  | 2.03             | mA | —  |
| I <sub>DD_PSTOP2</sub> | 局部停止 2, 内核和系统时钟禁用, Flash 休眠模式使能, 12 MHz 总线, V <sub>DD</sub> = 3.0 V  | —   | 0.881 | 1.18             | mA | —  |
| I <sub>DD_STOP</sub>   | 停止模式电流, 在 3.0 V 的电压下<br>• 25 °C 及以下  | —   | 158   | 175.7            |    | —  |

下一页继续介绍此表...

表 9. KL03 QFN 封装功耗特性 (继续)

| 符号                    | 说明   | 最小值 | 典型值  | 最大值 <sup>1</sup> | 单位 | 注释 |
|-----------------------|--|-----|------|------------------|----|----|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul>   | —   | 164  | 179.48           | μA |    |
| I <sub>DD_VLPS</sub>  | 极低功耗停止模式电流, 在 3.0 V 时 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul>            | —   | 2.2  | 2.71             | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPS</sub>  | 极低功耗停止模式电流, 在 1.8 V 时 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul>            | —   | 2.2  | 2.674            | μA | —  |
| I <sub>DD_VLLS3</sub> | 极低漏电停止模式 3 电流, 所有外设禁用, 在 3.0 V 时 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul> | —   | 1.08 | 1.17             | μA | —  |
| I <sub>DD_VLLS3</sub> | 极低漏电停止模式 3 电流及 RTC 电流, 在 3.0 V 时 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul> | —   | 1.47 | 1.56             | μA | —  |
| I <sub>DD_VLLS3</sub> | 极低漏电停止模式 3 电流及 RTC 电流, 在 1.8 V 时 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul> | —   | 1.33 | 1.42             | μA | —  |
| I <sub>DD_VLLS1</sub> | 极低漏电停止模式 1 电流, 所有外设禁用, 在 3.0 V 时 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> <li>• 105 °C 时</li> </ul> | —   | 566  | 690              | nA | —  |

下一页继续介绍此表...

**表 9. KL03 QFN 封装功耗特性 (继续)**

| 符号                    | 说明  | 最小值 | 典型值  | 最大值 <sup>1</sup> | 单位 | 注释 |
|-----------------------|---|-----|------|------------------|----|----|
| I <sub>DD_VLLS1</sub> | 极低功耗漏电停止模式 1 电流, RTC 使能, 在 3.0 V 时<br>• 25 °C 及以下<br>• 50°C 时<br>• 85°C 时<br>• 105 °C 时                           | —   | 969  | 1059             | nA | —  |
|                       |   | —   | 1200 | 1251             |    |    |
|                       |   | —   | 2740 | 3070             |    |    |
|                       |   | —   | 5610 | 6450             |    |    |
| I <sub>DD_VLLS1</sub> | 极低功耗漏电停止模式 1 电流, RTC 使能, 在 1.8 V 时<br>• 25 °C 及以下<br>• 50°C 时<br>• 85°C 时<br>• 105 °C 时                           | —   | 826  | 916              | nA | —  |
|                       |   | —   | 1040 | 1091             |    |    |
|                       |   | —   | 2400 | 2730             |    |    |
|                       |   | —   | 4910 | 5750             |    |    |
| I <sub>DD_VLLS0</sub> | 极低漏电停止模式 0 电流, 所有外设禁用 (SMC_STOPCTRL[PORPO] = 0), 在 3.0 V 时<br>• 25 °C 及以下<br>• 50 °C 时<br>• 85 °C 时<br>• 105 °C 时 | —   | 265  | 373              | nA | —  |
|                       |   | —   | 467  | 512.9            |    |    |
|                       |   | —   | 1920 | 2256             |    |    |
|                       |   | —   | 4540 | 5395             |    |    |
| I <sub>DD_VLLS0</sub> | 极低漏电停止模式 0 电流, 所有外设禁用 (SMC_STOPCTRL[PORPO] = 1), 在 3 V 时<br>• 25 °C 及以下<br>• 50 °C 时<br>• 85 °C 时<br>• 105 °C 时   | —   | 77   | 350              | nA | 4  |
|                       |   | —   | 255  | 465.70           |    |    |
|                       |   | —   | 1640 | 1994             |    |    |
|                       |   | —   | 4080 | 4956             |    |    |

1. 最大值表示相当于均值加上三倍标准偏差的表征结果 (均值 + 3 倍标准差)。
2. 模拟供电电流等于器件上每个模拟模块的工作或禁用电流之和。有关各个模块的供电电流, 请参见其规格。
3. MCG\_Lite 配置为 HIRC 模式。通过 IAR 7.10 以高优化级别编译 CoreMark 基准代码, 针对平衡优化。
4. 无掉电

**表 10. KL03 WLCSP 封装功耗特性**

| 符号                    | 说明   | 最小值 | 典型值  | 最大值 <sup>1</sup> | 单位 | 注释 |
|-----------------------|--|-----|------|------------------|----|----|
| I <sub>DDA</sub>      | 模拟供电电流   | —   | —    | 参见注释             | mA | 2  |
| I <sub>DD_RUNCO</sub> | 在计算操作模式下运行 Flash 中的 CoreMark - 48M HIRC 模式, 48 MHz 内核/ 24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br>• 25 °C 时<br>• 85 °C 时 | —   | 5.49 | 5.71             | mA | 3  |
|                       |  | —   | 5.59 | 5.81             |    |    |

下一页继续介绍此表...

**表 10. KL03 WLCSP 封装功耗特性 (继续)**

| 符号                    | 说明  | 最小值 | 典型值  | 最大值 <sup>1</sup> | 单位 | 注释 |
|-----------------------|---|-----|------|------------------|----|----|
| I <sub>DD_RUNCO</sub> | 在计算操作模式下运行 Flash 中的 While(1)循环 - 48M HIRC 模式, 48 MHz 内核/ 24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>           | —   | 5.16 | 5.37             | mA | 3  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 CoreMark, 所有外设时钟禁用, 48 MHz 内核/24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>    | —   | 6.03 | 6.27             | mA | 3  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 CoreMark, 所有外设时钟禁用, 24 MHz 内核/12 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>    | —   | 3.71 | 3.86             | mA | 3  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 CoreMark, 所有外设时钟禁用, 12 MHz 内核/6 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>     | —   | 2.47 | 2.57             | mA | 3  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 CoreMark, 所有外设时钟启用, 48 MHz 内核/24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>    | —   | 6.43 | 6.69             | mA | 3  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 48 MHz 内核/ 24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul> | —   | 5.71 | 5.94             | mA | —  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 24 MHz 内核/ 12 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul> | —   | 3.3  | 3.43             | mA | —  |
| I <sub>DD_RUN</sub>   | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 12 MHz 内核/ 6 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>  | —   | 2.28 | 2.37             | mA | —  |

下一页继续介绍此表...

表 10. KL03 WLCSP 封装功耗特性 (继续)

| 符号                     | 说明  | 最小值 | 典型值  | 最大值 <sup>1</sup> | 单位 | 注释 |
|------------------------|---|-----|------|------------------|----|----|
| I <sub>DD_RUN</sub>    | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟启用, 48 MHz 内核/24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> <li>85 °C 时</li> </ul> | —   | 6.1  | 6.34             | mA | —  |
| I <sub>DD_RUN</sub>    | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 SRAM 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 48 MHz 内核/24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> <li>85 °C 时</li> </ul>  | —   | 3.14 | 3.23             | mA | —  |
| I <sub>DD_RUN</sub>    | 运行模式电流 - 48M HIRC 模式, 运行 SRAM 中的 While(1)循环, 所有外设时钟启用, 48 MHz 内核/24 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> <li>85 °C 时</li> </ul>  | —   | 3.54 | 3.63             | mA | —  |
| I <sub>DD_VLPRCO</sub> | 在计算操作模式下极低功耗运行 Flash 中的 While(1)循环 - 2 MHz LIRC 模式, 2 MHz 内核/0.5 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>                      | —   | 500  | 750              | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPRCO</sub> | 在计算操作模式下极低功耗运行 SRAM 中的 While(1)循环 - 8 MHz LIRC 模式, 4 MHz 内核/1 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>                         | —   | 188  | 217              | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPRCO</sub> | 在计算操作模式下极低功耗运行 SRAM 中的 While(1)循环 - 2 MHz LIRC 模式, 2 MHz 内核/0.5 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>                       | —   | 82   | 123              | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 2 MHz 内核/0.5 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>               | —   | 503  | 754              | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 125 kHz 内核/31.25 kHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>           | —   | 60   | 90               | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, Flash 中的 While(1)循环, 所有外设时钟启用, 2 MHz 内核/0.5 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>               | —   | 516  | 774              | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 8 MHz LIRC 模式, SRAM 中的 While(1)循环, 所有外设时钟禁用, 4 MHz 内核/1 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br><ul style="list-style-type: none"> <li>25 °C 时</li> </ul>                  | —   | 209  | 350              | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 8 MHz LIRC 模式, SRAM 中的 While(1)循环, 所有外设时钟启用, 4 MHz 内核/1 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V   |     |      |                  |    | —  |

下一页继续介绍此表...



表 10. KL03 WLCSP 封装功耗特性 (继续)

| 符号                     | 说明  | 最小值         | 典型值                | 最大值 <sup>1</sup>          | 单位 | 注释 |
|------------------------|---|-------------|--------------------|---------------------------|----|----|
|                        | • 25 °C 时   | —           | 229                | 370                       | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, SRAM 中的 While(1) 循环, 所有外设时钟禁用, 2 MHz 内核/ 0.5 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br>• 25 °C 时    | —           | 93                 | 140                       | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, SRAM 中的 While(1) 循环, 所有外设时钟禁用, 125 kHz 内核/31.25 kHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br>• 25 °C 时 | —           | 31                 | 81                        | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPR</sub>   | 极低功耗运行模式电流 - 2 MHz LIRC 模式, SRAM 中的 While(1) 循环, 所有外设时钟启用, 2 MHz 内核/ 0.5 MHz Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V<br>• 25 °C 时    | —           | 103                | 154                       | μA | —  |
| I <sub>DD_WAIT</sub>   | 待机模式电流 - 内核禁用, 48 MHz 系统/24 MHz 总线, Flash 禁用 (Flash 休眠模式使能), 所有外设时钟禁用, MCG_Lite 处于 HIRC 模式, V <sub>DD</sub> = 3.0 V         | —           | 1.4                | 1.94                      | mA | —  |
| I <sub>DD_WAIT</sub>   | 待机模式电流 - 内核禁用, 24 MHz 系统/12 MHz 总线, Flash 禁用 (Flash 休眠模式使能), 所有外设时钟禁用, MCG_Lite 处于 HIRC 模式, V <sub>DD</sub> = 3.0 V         | —           | 1.02               | 1.24                      | mA | —  |
| I <sub>DD_VLPW</sub>   | 极低功耗待机模式电流, 内核禁用, 4 MHz 系统/ 1 MHz 总线和 Flash, 所有外设时钟禁用, V <sub>DD</sub> = 3.0 V  | —           | 121                | 181                       | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPW</sub>   | 极低功耗待机模式电流, 内核禁用, 2 MHz 系统/0.5 MHz 总线和 Flash, 所有外设时钟禁用, V <sub>DD</sub> = 3.0 V   | —           | 59                 | 97                        | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPW</sub>   | 极低功耗待机模式电流, 内核禁用, 125 kHz 系统/31.25 kHz 总线和 Flash, 所有外设时钟禁用, V <sub>DD</sub> = 3.0 V   | —           | 28                 | 42                        | μA | —  |
| I <sub>DD_PSTOP2</sub> | 局部停止 2, 内核和系统时钟禁用, 12 MHz 总线和 Flash, V <sub>DD</sub> = 3.0 V  | —           | 1.53               | 2.03                      | mA | —  |
| I <sub>DD_PSTOP2</sub> | 局部停止 2, 内核和系统时钟禁用, Flash 休眠模式使能, 12 MHz 总线, V <sub>DD</sub> = 3.0 V   | —           | 0.881              | 1.18                      | mA | —  |
| I <sub>DD_STOP</sub>   | 停止模式电流, 在 3.0 V 的电压下<br>• 25 °C 及以下<br>• 50 °C 时<br>• 85 °C 时   | —<br>—<br>— | 158<br>164<br>187  | 175.7<br>179.48<br>199.54 | μA | —  |
| I <sub>DD_VLPS</sub>   | 极低功耗停止模式电流, 在 3.0 V 时<br>• 25 °C 及以下<br>• 50 °C 时<br>• 85 °C 时  | —<br>—<br>— | 2.2<br>3.9<br>13.9 | 2.71<br>6.63<br>18.25     | μA | —  |

下一页继续介绍此表...

表 10. KL03 WLCSP 封装功耗特性 (继续)

| 符号                    | 说明  | 最小值 | 典型值  | 最大值 <sup>1</sup> | 单位 | 注释 |
|-----------------------|---|-----|------|------------------|----|----|
| I <sub>DD_VLPS</sub>  | 极低功耗停止模式电流, 在 1.8 V 时<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>                                      | —   | 2.2  | 2.674            | μA | —  |
|                       |   | —   | 3.8  | 6.44             |    |    |
|                       |   | —   | 13.2 | 17.37            |    |    |
| I <sub>DD_VLLS3</sub> | 极低漏电停止模式 3 电流, 所有外设禁用, 在 3.0 V 时<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>                           | —   | 1.08 | 1.17             | μA | —  |
|                       |   | —   | 1.4  | 1.52             |    |    |
|                       |   | —   | 3.45 | 3.96             |    |    |
| I <sub>DD_VLLS3</sub> | 极低漏电停止模式 3 电流及 RTC 电流, 在 3.0 V 时<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>                           | —   | 1.47 | 1.56             | μA | —  |
|                       |   | —   | 1.82 | 1.94             |    |    |
|                       |   | —   | 3.93 | 4.44             |    |    |
| I <sub>DD_VLLS3</sub> | 极低漏电停止模式 3 电流及 RTC 电流, 在 1.8 V 时<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>                           | —   | 1.33 | 1.42             | μA | —  |
|                       |   | —   | 1.65 | 1.77             |    |    |
|                       |   | —   | 3.56 | 4.07             |    |    |
| I <sub>DD_VLLS1</sub> | 极低漏电停止模式 1 电流, 所有外设禁用, 在 3.0 V 时<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>                           | —   | 566  | 690              | nA | —  |
|                       |   | —   | 788  | 839              |    |    |
|                       |   | —   | 2270 | 2600             |    |    |
| I <sub>DD_VLLS1</sub> | 极低功耗漏电停止模式 1 电流, RTC 使能, 在 3.0 V 时<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>                         | —   | 969  | 1059             | nA | —  |
|                       |   | —   | 1200 | 1251             |    |    |
|                       |   | —   | 2740 | 3070             |    |    |
| I <sub>DD_VLLS1</sub> | 极低功耗漏电停止模式 1 电流, RTC 使能, 在 1.8 V 时<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul>                         | —   | 826  | 916              | nA | —  |
|                       |   | —   | 1040 | 1091             |    |    |
|                       |   | —   | 2400 | 2730             |    |    |
| I <sub>DD_VLLS0</sub> | 极低漏电停止模式 0 电流, 所有外设禁用 (SMC_STOPCTRL[PORPO] = 0), 在 3.0 V 时<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul> | —   | 265  | 373              | nA | —  |
|                       |   | —   | 467  | 512.9            |    |    |
|                       |   | —   | 1920 | 2256             |    |    |

下一页继续介绍此表...

**表 10. KL03 WLCSP 封装功耗特性 (继续)**

| 符号                    | 说明   | 最小值 | 典型值  | 最大值 <sup>1</sup> | 单位 | 注释 |
|-----------------------|--|-----|------|------------------|----|----|
| I <sub>DD_VLLS0</sub> | 极低漏电停止模式 0 电流, 所有外设禁用 (SMC_STOPCTRL[PORPO] = 1), 在 3 V 时 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 °C 及以下</li> <li>• 50 °C 时</li> <li>• 85 °C 时</li> </ul> | —   | 77   | 350              | nA | 4  |
|                       |  | —   | 255  | 465.70           |    |    |
|                       |  | —   | 1640 | 1994             |    |    |

1. 最大值表示相当于均值加上三倍标准偏差的表征结果 (均值 + 3 倍标准差)。
2. 模拟供电电流等于器件上每个模拟模块的工作或禁用电流之和。有关各个模块的供电电流, 请参见其规格。
3. MCG\_Lite 配置为 HIRC 模式。通过 IAR 7.10 以高优化级别编译 CoreMark 基准代码, 针对平衡优化。
4. 无掉电

**表 11. 低功耗模式外设增加的电流 — 典型值**

| 符号                         | 说明   | 温度(°C) |     |     |     |     |                  | 单位 |
|----------------------------|--|--------|-----|-----|-----|-----|------------------|----|
|                            |  | -40    | 25  | 50  | 70  | 85  | 105 <sup>1</sup> |    |
| I <sub>LIRC8MHz</sub>      | 8 MHz 内部参考时钟(LIRC)增加电流。进入 STOP 或 VLPS 模式且使能 8 MHz LIRC、在 MCG_SC[FCDIV]=000b、MCG_MC[LIRC_DIV2]=000b 时进行测量。  | 68     | 68  | 68  | 68  | 68  | 68               | μA |
| I <sub>LIRC2MHz</sub>      | 2 MHz 内部参考时钟(LIRC)增加电流。进入 STOP 模式且使能 2 MHz LIRC、在 MCG_SC[FCDIV]=000b、MCG_MC[LIRC_DIV2]=000b 时进行测量。   | 27     | 27  | 27  | 27  | 27  | 27               | μA |
| I <sub>EREFSTEN32KHz</sub> | 外部 32 kHz 晶振时钟增加电流, 通过 OSC0_CR[EREFSTEN 和 EREFSTEN] 位来选择。通过在晶振使能情况下进入所有模式而测得。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• VLLS1</li> <li>• VLLS3</li> <li>• VLPS</li> <li>• STOP</li> </ul> | 340    | 410 | 460 | 470 | 480 | 600              | nA |
|                            |  | 340    | 410 | 460 | 490 | 530 | 600              |    |
|                            |  | 340    | 420 | 480 | 570 | 610 | 850              |    |
|                            |  | 340    | 420 | 480 | 570 | 610 | 850              |    |
| I <sub>LPTMR</sub>         | LPTMR 外设增加电流, 通过将设备置于 VLLS1 模式且使用 LPO 使能 LPTMR 进行测量。   | 30     | 30  | 30  | 85  | 100 | 200              | nA |
|                            |  |        |     |     |     |     |                  |    |
| I <sub>CMP</sub>           | CMP 外设增加电流, 通过进入 VLLS1 模式进行测量, 其中使用 6 位 DAC 和单个外部输入进行比较来使能 CMP。包括 6 位 DAC 的功耗。   | 15     | 15  | 15  | 15  | 15  | 15               | μA |
| I <sub>RTC</sub>           | RTC 外设增加电流, 通过进入 VLLS1 模式进行测量, 其中通过 RTC_CR[OSCE] 位使能外部 32 kHz 晶振并将 RTC ALARM 设为 1 分钟。包括 ERCLK32K (32 kHz 外部晶振) 功耗。   | 340    | 440 | 440 | 480 | 520 | 620              | nA |

下一页继续介绍此表...

表 11. 低功耗模式外设增加的电流 — 典型值 (继续)

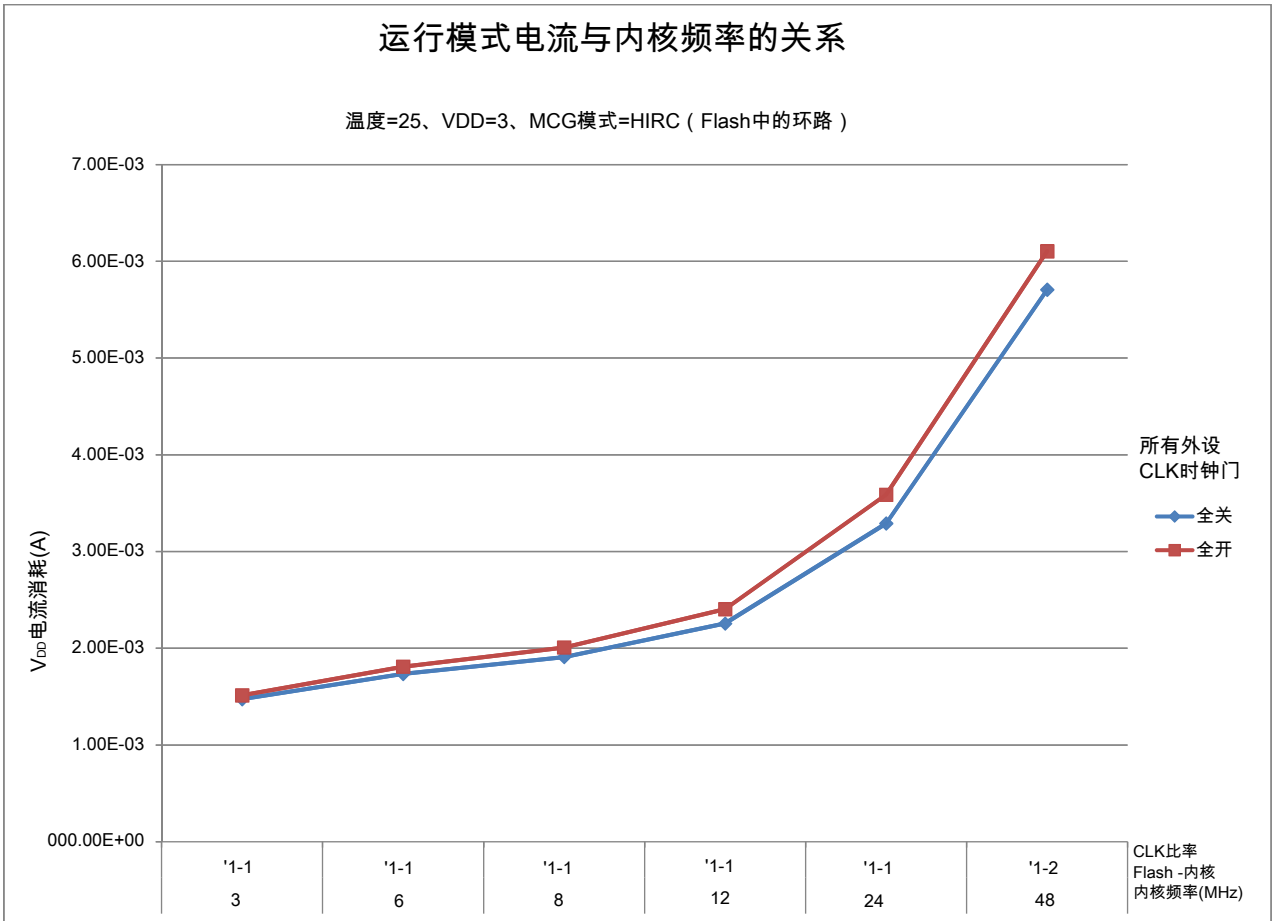
| 符号                | 说明  | 温度(°C) |     |     |     |     |                  | 单位 |
|-------------------|---|--------|-----|-----|-----|-----|------------------|----|
|                   |   | -40    | 25  | 50  | 70  | 85  | 105 <sup>1</sup> |    |
| I <sub>UART</sub> | UART 外设增加电流，通过进入 STOP 或者 VLPS 模式进行测量，其中使选定时钟源以 115200 波特率等待 RX 数据。包括选定的时钟源功耗。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• LIRC8M (8 MHz 内部参考时钟)</li> <li>• LIRC2M (2 MHz 内部参考时钟)</li> </ul>                          | 85     | 85  | 85  | 85  | 85  | 85               | μA |
|                   |   | 28     | 28  | 28  | 28  | 28  | 28               |    |
| I <sub>TPM</sub>  | TPM 外设增加电流，通过进入 STOP 或者 VLPS 模式进行测量，其中配置用于输出比较的选定时钟源生成 100 Hz 信号。产生时钟信号的 I/O 上不存在负载。包括选定时钟源和 I/O 开关电流。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• LIRC8M (8 MHz 内部参考时钟)</li> <li>• LIRC2M (2 MHz 内部参考时钟)</li> </ul> | 93     | 93  | 93  | 93  | 93  | 93               | μA |
|                   |   | 35     | 35  | 35  | 35  | 35  | 35               |    |
| I <sub>BG</sub>   | BGEN 位置位且器件处于 VLPx 或 VLLSx 模式时的带隙增加电流。  | 45     | 45  | 45  | 45  | 45  | 45               | μA |
| I <sub>ADC</sub>  | ADC 外设增加电流，V <sub>DD</sub> 和 V <sub>DDA</sub> 时测量值的组合，通过进入 STOP 或者 VLPS 模式进行测量。采用内部时钟将 ADC 配置为低功耗模式，并继续执行转换操作。  | 340    | 340 | 340 | 340 | 340 | 340              | μA |

1. 仅限 QFN 封装。

### 2.2.5.1 示意图: 典型 IDD\_RUN 工作特性

下面的数据是在以下条件下测定的:

- MCG-Lite 在运行模式下是 HIRC 模式，在 VLPR 模式下是 LIRC 模式
- 无 GPIO 切换
- 从 Flash 执行代码且使能高速缓存
- 对于 ALLOFF 曲线，禁用除 FTFA 外的全部外设时钟



**图 3. 运行模式供电电流与内核频率 (Flash 中的环路)**

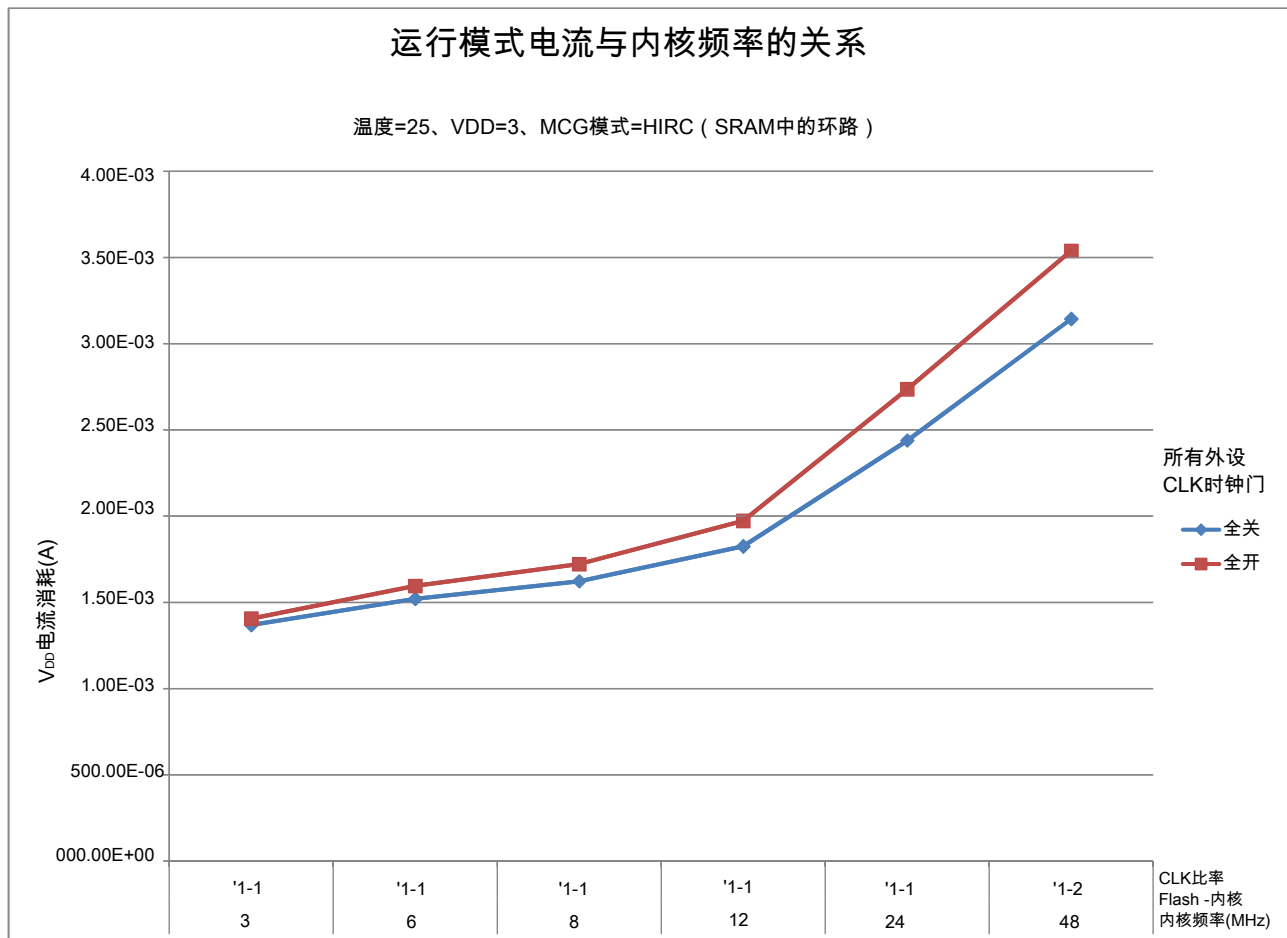
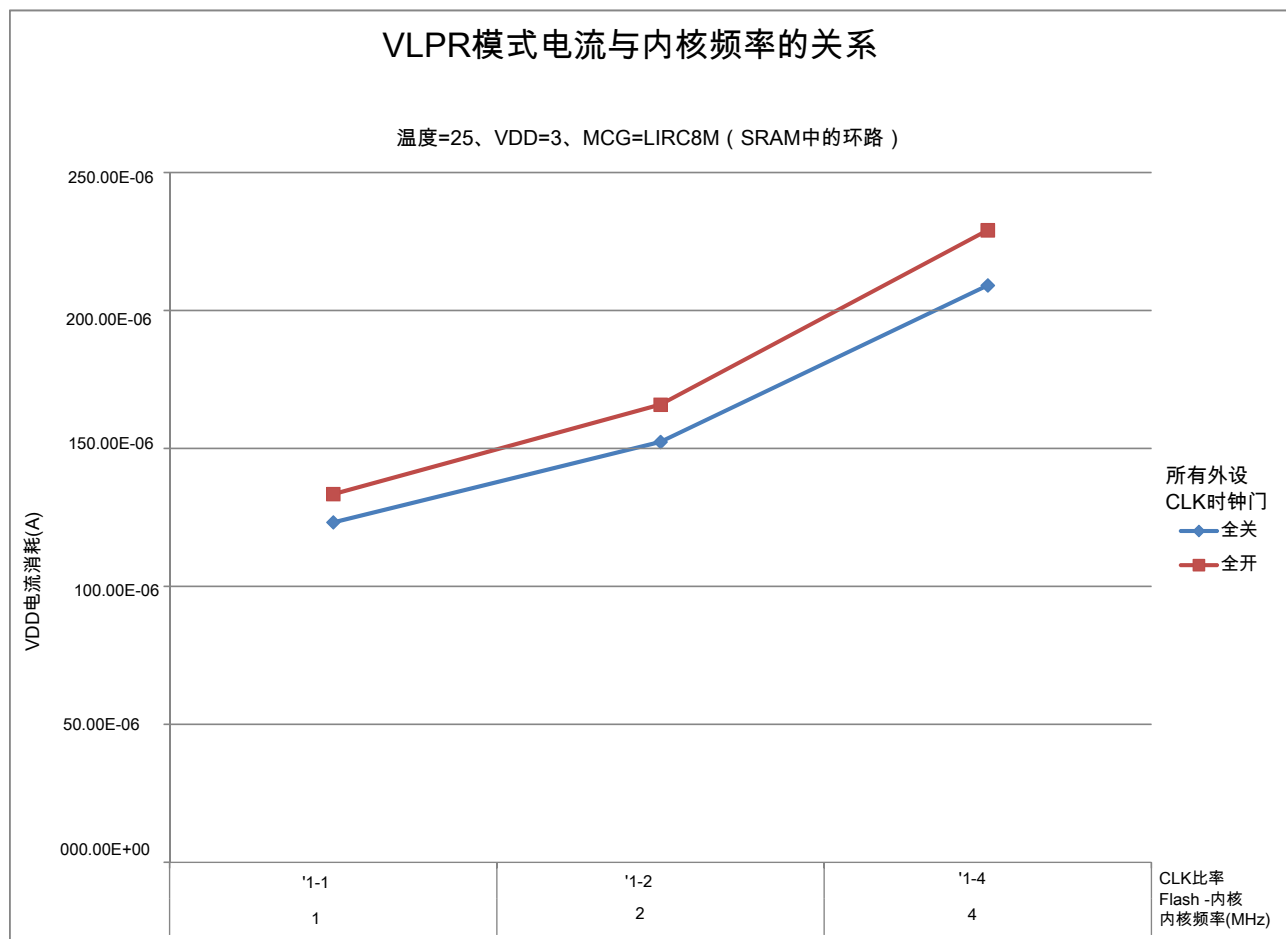


图 4. 运行模式供电电流与内核频率 (SRAM 中的环路)



**图 5. VLPR 模式电流与内核频率 (SRAM 中的环路)**

## 2.2.6 EMC 电磁辐射特性

**表 12. 24 引脚 QFN 封装的 EMC 电磁辐射特性**

| 符号            | 说明           | 频带(MHz)   | 典型值 | 单位         | 注释   |
|---------------|--------------|-----------|-----|------------|------|
| $V_{RE1}$     | 电磁辐射电压, 频带 1 | 0.15–50   | 5   | dB $\mu$ V | 1, 2 |
| $V_{RE2}$     | 电磁辐射电压, 频带 2 | 50–150    | 7   | dB $\mu$ V |      |
| $V_{RE3}$     | 电磁辐射电压, 频带 3 | 150–500   | 5   | dB $\mu$ V |      |
| $V_{RE4}$     | 电磁辐射电压, 频带 4 | 500–1000  | 5   | dB $\mu$ V |      |
| $V_{RE\_IEC}$ | IEC/SAE 级别   | 0.15–1000 | N   | —          | 2, 3 |

1. 根据 IEC 61967-2 ( 和 SAE J1752/3 ) 电磁射频(RF)辐射测量标准确定。典型配置 : 附录 B : DUT 软件配置 - 2。典型配置。
2.  $V_{DD} = 3.3\text{ V}$ ,  $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $f_{irc48m} = 48\text{ MHz}$ ,  $f_{SYS} = 48\text{ MHz}$ ,  $f_{BUS} = 24\text{ MHz}$
3. IEC/SAE 级别最大值 :  $N \leq 12\text{ dB}\mu\text{V}$ ,  $M \leq 18\text{ dB}\mu\text{V}$ ,  $L \leq 24\text{ dB}\mu\text{V}$ ,  $K \leq 30\text{ dB}\mu\text{V}$ ,  $I \leq 36\text{ dB}\mu\text{V}$ ,  $H \leq 42\text{ dB}\mu\text{V}$ ,  $G \leq 48\text{ dB}\mu\text{V}$ 。

## 2.2.7 设计时需考虑电磁辐射

如果需要查找应用笔记，以便于指导系统设计以最大限度减少电磁辐射干扰：

1. 请访问 [www.freescale.com](http://www.freescale.com)。
2. 输入“EMC design”执行关键字搜索。

## 2.2.8 电容属性

表 13. 电容属性

| 符号              | 说明   | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|------|-----|-----|----|
| C <sub>IN</sub> | 输入电容 | —   | 7   | pF |

## 2.3 开关特性

### 2.3.1 器件时钟特性

表 14. 器件时钟特性

| 符号                          | 说明                    | 最小值 | 最大值 | 单位  |
|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| 正常运行模式                      |                       |     |     |     |
| f <sub>SYS</sub>            | 系统和内核时钟               | —   | 48  | MHz |
| f <sub>BUS</sub>            | 总线时钟                  | —   | 24  | MHz |
| f <sub>FLASH</sub>          | Flash 时钟              | —   | 24  | MHz |
| f <sub>LPTMR</sub>          | LPTMR 时钟              | —   | 24  | MHz |
| VLPR 和 VLPS 模式 <sup>1</sup> |                       |     |     |     |
| f <sub>SYS</sub>            | 系统和内核时钟               | —   | 4   | MHz |
| f <sub>BUS</sub>            | 总线时钟                  | —   | 1   | MHz |
| f <sub>FLASH</sub>          | Flash 时钟              | —   | 1   | MHz |
| f <sub>LPTMR</sub>          | LPTMR 时钟 <sup>2</sup> | —   | 24  | MHz |
| f <sub>ERCLK</sub>          | 外部参考时钟                | —   | 16  | MHz |
| f <sub>LPTMR_ERCLK</sub>    | LPTMR 外部参考时钟          | —   | 16  | MHz |
| f <sub>TPM</sub>            | TPM 异步时钟              | —   | 8   | MHz |
| f <sub>UART0</sub>          | UART0 异步时钟            | —   | 8   | MHz |

1. VLPR 和 VLPS 模式下的频率限制会覆盖其他所有模块时序特性中的一切频率特性。无论是从 RUN 还是从 VLPR 进入 VLPS，VLPS 也适用同样的频率限制。
2. 仅当信号源为外部引脚时，才能在 VLPR 或 VLPS 下以此速度向 LPTMR 提供时钟。



## 2.3.2 一般开关规格

这些一般规格适用于配置为 GPIO 和 UART 的所有信号。

表 15. 一般开关规格

| 说明                               | 最小值 | 最大值 | 单位     | 注释 |
|----------------------------------|-----|-----|--------|----|
| GPIO 引脚中断脉冲宽度（数字毛刺滤波器禁用）— 同步路径   | 1.5 | —   | 总线时钟周期 | 1  |
| 外部 reset_b 和 NMI 引脚中断脉冲宽度 — 异步路径 | 100 | —   | ns     | 2  |
| GPIO 引脚中断脉冲宽度 — 异步路径             | 16  | —   | ns     | 2  |
| 端口上升和下降时间                        | —   | 36  | ns     | 3  |

1. 必须满足更高的同步和异步时序要求。
2. 这是保证可以识别的最短脉冲。
3. 75 pF 负载

## 2.4 热学特性

### 2.4.1 热学操作要求

表 16. WLCSP 封装的热学操作要求

| 符号    | 说明   | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|------|-----|-----|----|
| $T_J$ | 裸片结温 | -40 | 95  | °C |
| $T_A$ | 环境温度 | -40 | 85  | °C |

表 17. 其他封装的热学操作要求

| 符号    | 说明   | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|------|-----|-----|----|
| $T_J$ | 裸片结温 | -40 | 125 | °C |
| $T_A$ | 环境温度 | -40 | 105 | °C |

## 2.4.2 热属性

表 18. 热属性

| 板类型      | 符号               | 说明                            | 16 QFN | 20 WLCSP | 24 QFN | 单位   | 注释      |
|----------|------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|------|---------|
| 单层(1S)   | $R_{\theta JA}$  | 热阻, 连接到外部环境 (自然对流)            | 64.2   | 69.8     | 60.7   | °C/W | 1, 2    |
| 四层(2s2p) | $R_{\theta JA}$  | 热阻, 连接到外部环境 (自然对流)            | 53.3   | 57.5     | 48.5   | °C/W | 1, 2, 3 |
| 单层(1S)   | $R_{\theta JMA}$ | 热阻, 连接到外部环境 (空气速率为 200 英尺/分钟) | 55.4   | 62.03    | 51.0   | °C/W | 1, 3    |
| 四层(2s2p) | $R_{\theta JMA}$ | 热阻, 连接到外部环境 (空气速率为 200 英尺/分钟) | 48.9   | 54.3     | 43.6   | °C/W | 1, 3    |
| —        | $R_{\theta JB}$  | 热阻, 连接到板                      | 33.5   | 51.64    | 30.4   | °C/W | 4       |
| —        | $R_{\theta JC}$  | 热阻, 连接到管壳                     | 20.9   | 0.73     | 9.8    | °C/W | 5       |
| —        | $\Psi_{JT}$      | 热特性参数, 连接到外封装顶部中心 (自然对流)      | 0.2    | 0.2      | 0.2    | °C/W | 6       |
| —        | $\Psi_{JB}$      | 热特性参数, 连接到外封装底部中心 (自然对流)      | 22.4   |          | 21.8   | °C/W | 7       |

1. 结温是裸片大小、片上功耗、封装热阻、安装环境 (板) 温度、环境温度、气流、板上其他组件的功耗和板热阻的函数。
2. 基于 SEMI G38-87 和 JEDEC JESD51-2 标准, 在单层板水平方向。
3. 基于 JEDEC JESD51-6, 在电路板水平方向。
4. 裸片和印刷电路板上的热阻, 基于 JEDEC JESD51-8 的标准。板温度在封装附近的板上表面测量。
5. 通过冷板方法测量裸片和管壳顶部之间的热阻 (MIL SPEC-883 Method 1012.1)。
6. 基于 JEDEC JESD51-2 标准, 热特性参数表示封装顶部和结温度之间的温差。未提供希腊字母时, 散热特性参数写为 Psi-JT。
7. 基于 JEDEC JESD51-12 标准, 热特性参数表示封装底部中心和结温度之间的温差。未提供希腊字母时, 散热特性参数写为 Psi-JB。

## 3 外设工作要求与特性

### 3.1 内核模块

#### 3.1.1 SWD 电气特性

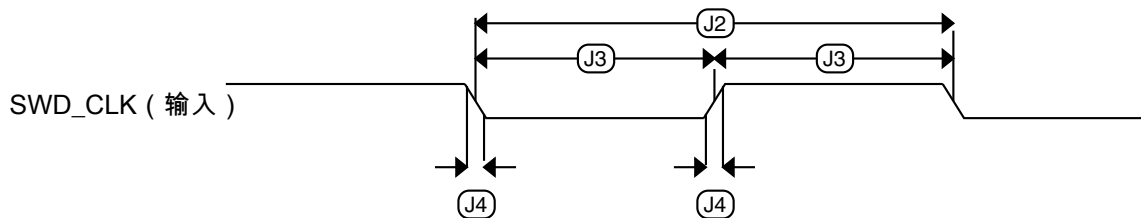
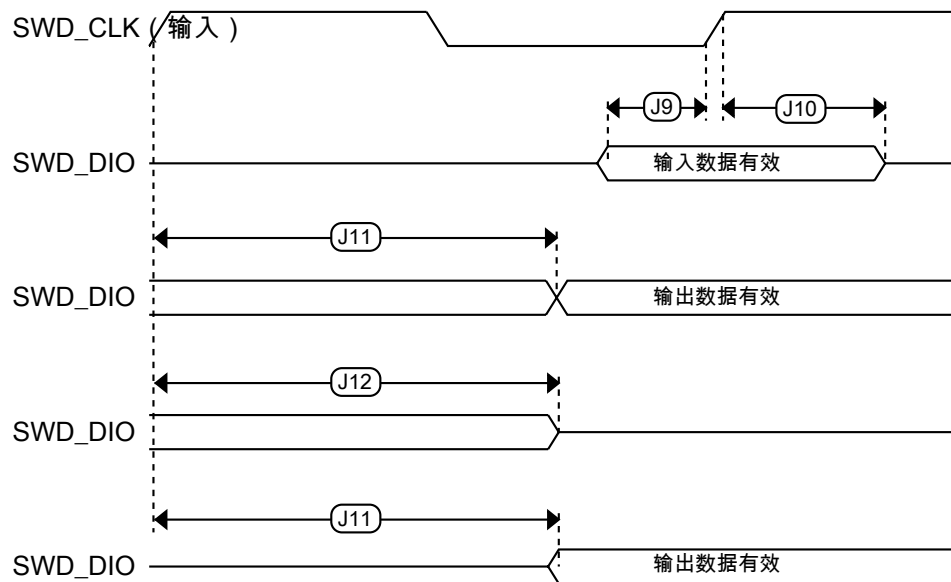
表 19. SWD 全电压范围电气特性

| 符号 | 说明                      | 最小值  | 最大值 | 单位  |
|----|-------------------------|------|-----|-----|
|    | 工作电压                    | 1.71 | 3.6 | V   |
| J1 | SWD_CLK 操作频率<br>• 串行线调试 | 0    | 25  | MHz |

下一页继续介绍此表...

**表 19. SWD 全电压范围电气特性 (继续)**

| 符号  | 说明                            | 最小值  | 最大值 | 单位 |
|-----|-------------------------------|------|-----|----|
| J2  | SWD_CLK 周期                    | 1/J1 | —   | ns |
| J3  | SWD_CLK 时钟脉冲宽度<br>• 串行线调试     | 20   | —   | ns |
| J4  | SWD_CLK 上升和下降时间               | —    | 3   | ns |
| J9  | SWD_CLK 上升前的 SWD_DIO 输入数据建立时间 | 10   | —   | ns |
| J10 | SWD_DIO 输入数据至 SWD_CLK 上升的保持时间 | 0    | —   | ns |
| J11 | SWD_CLK 高电平至 SWD_DIO 数据有效时间   | —    | 32  | ns |
| J12 | SWD_CLK 高电平至 SWD_DIO 高阻态时间    | 5    | —   | ns |


**图 6. 串行线时钟输入时序**

**图 7. 串行线数据时序**

## 3.2 系统模块

对于器件的系统模块，无特性要求。

## 3.3 时钟模块

### 3.3.1 MCG-Lite 规格

表 20. HIRC48M 规格

| 符号                         | 说明   | 最小值  | 典型值   | 最大值  | 单位                   | 注释 |
|----------------------------|--|------|-------|------|----------------------|----|
| V <sub>DD</sub>            | 供电电压                                       | 1.71 | —     | 3.6  | V                    | —  |
| I <sub>DD48M</sub>         | 供电电流                                       | —    | 400   | 500  | μA                   | —  |
| f <sub>irc48m</sub>        | 内部参考频率                                     | —    | 48    | —    | MHz                  | —  |
| Δf <sub>irc48m_ol_lv</sub> | IRC48M 在低电压(VDD=1.71V-1.89V)条件下随温度变化的频率总偏差 | —    | ± 0.5 | ±1.5 | %f <sub>irc48m</sub> | —  |
| Δf <sub>irc48m_ol_hv</sub> | IRC48M 在高电压(VDD=1.89V-3.6V)条件下随温度变化的频率总偏差  | —    | ± 0.5 | ±1.0 | %f <sub>irc48m</sub> | —  |
| J <sub>cyc_irc48m</sub>    | 周期抖动(RMS)                                  | —    | 35    | 150  | ps                   | —  |
| t <sub>irc48mst</sub>      | 启动时间                                       | —    | 2     | 3    | μs                   | 1  |

1. IRC48M 启动时间的定义为：从时钟使能操作至时钟可供系统使用之间的时间。通过将 MCG\_MC[HIRCEN]设为 1 使能时钟。详情请参见参考手册。

表 21. LIRC8M/2M 规格

| 符号                    | 说明             | 最小值  | 典型值 | 最大值  | 单位                | 注释                      |
|-----------------------|----------------|------|-----|------|-------------------|-------------------------|
| V <sub>DD</sub>       | 供电电压           | 1.08 | —   | 1.47 | V                 | —                       |
| T                     | 温度范围           | -40  | —   | 125  | °C                | —                       |
| I <sub>DD_2M</sub>    | 2 MHz 模式下的供电电流 | —    | 14  | 17   | μA                | —                       |
| I <sub>DD_8M</sub>    | 8 MHz 模式下的供电电流 | —    | 30  | 35   | μA                | —                       |
| f <sub>IRC_2M</sub>   | 输出频率           | —    | 2   | —    | MHz               | —                       |
| f <sub>IRC_8M</sub>   | 输出频率           | —    | 8   | —    | MHz               | —                       |
| f <sub>IRC_T_2M</sub> | 输出频率范围 (已调整)   | —    | —   | ±3   | %f <sub>IRC</sub> | V <sub>DD</sub> ≥1.89 V |
| f <sub>IRC_T_8M</sub> | 输出频率范围 (已调整)   | —    | —   | ±3   | %f <sub>IRC</sub> | V <sub>DD</sub> ≥1.89 V |
| T <sub>su_2M</sub>    | 启动时间           | —    | —   | 12.5 | μs                | —                       |
| T <sub>su_8M</sub>    | 启动时间           | —    | —   | 12.5 | μs                | —                       |

### 3.3.2 振荡器电气特性

#### 3.3.2.1 直流振荡器电气特性

表 22. 直流振荡器电气特性

| 符号                    | 说明                       | 最小值  | 典型值 | 最大值 | 单位         | 注释   |
|-----------------------|--------------------------|------|-----|-----|------------|------|
| $V_{DD}$              | 供电电压                     | 1.71 | —   | 3.6 | V          | —    |
| $I_{DDOSC}$           | 供电电流 - 低功耗模式<br>• 32 kHz | —    | 500 | —   | nA         | 1    |
| $C_x$                 | EXTAL 管脚负载电容             | —    | —   | —   |            | 2, 3 |
| $C_y$                 | XTAL 管脚负载电容              | —    | —   | —   |            | 2, 3 |
| $R_F$                 | 反馈电阻 - 低频、低功耗模式          | —    | —   | —   | M $\Omega$ | 2, 4 |
| $R_S$                 | 串联电阻 - 低频、低功耗模式          | —    | —   | —   | k $\Omega$ | —    |
| $V_{pp}$ <sup>5</sup> | 峰峰值 (振荡器模式) - 低频、低功耗模式   | —    | 0.6 | —   | V          | —    |

1.  $V_{DD}=3.3$  V, 温度 =25° C
2. 参见晶振或谐振器制造商的建议
3. 可使用内部集成电容或外部组件来提供  $C_x$ 、 $C_y$ 。
4. 选择低功耗模式时,  $R_F$  仅使用内部集成电阻, 而不能使用外部电阻。
5. EXTAL 和 XTAL 引脚只应连接到所需的振荡器组件, 而不得连接到其他任何器件。

#### 3.3.2.2 振荡器频率特性

表 23. 振荡器频率特性

| 符号              | 说明                       | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位  | 注释   |
|-----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| $f_{osc\_lo}$   | 振荡器晶振频率或谐振器频率 - 低频模式     | 32  | —   | 40  | kHz | —    |
| $t_{dc\_extal}$ | 输入时钟占空比 (外部时钟模式)         | 40  | 50  | 60  | %   | —    |
| $t_{cst}$       | 晶振启动时间 - 32 kHz 低频、低功耗模式 | —   | 750 | —   | ms  | 1, 2 |

1. 为了达到规格要求, 必须遵循适当的 PCB 布局规程。
2. 晶振启动时间定义为从振荡器使能到 MCG\_S 寄存器中的 OSCINIT 位置位之间的时间长度。

## 3.4 存储器和存储器接口

### 3.4.1 Flash 电气特性

本节介绍 Flash 存储器模块的电气特性。

### 3.4.1.1 Flash 时序特性 — 编程和擦除

下列规格表示内部电荷泵处于有效状态的时间，不包括命令执行时间。

表 24. NVM 编程/擦除时序特性

| 符号                    | 说明        | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位            | 注释 |
|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|---------------|----|
| $t_{hvp\text{gm}4}$   | 长字编程高电压时间 | —   | 7.5 | 18  | $\mu\text{s}$ | —  |
| $t_{h\text{versscr}}$ | 扇区擦除高电压时间 | —   | 13  | 113 | ms            | 1  |
| $t_{h\text{versall}}$ | 全部擦除高电压时间 | —   | 52  | 452 | ms            | 1  |

1. 最大时间，基于循环周期终止时的期望值。

### 3.4.1.2 Flash 时序特性 - 命令

表 25. Flash 命令时序特性

| 符号                           | 说明                      | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位            | 注释 |
|------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|---------------|----|
| $t_{rd1\text{sec}1\text{k}}$ | “读 1s 区”执行时间 (Flash 扇区) | —   | —   | 60  | $\mu\text{s}$ | 1  |
| $t_{pgm\text{chk}}$          | “程序校验”执行时间              | —   | —   | 45  | $\mu\text{s}$ | 1  |
| $t_{rd\text{src}}$           | “读资源”执行时间               | —   | —   | 30  | $\mu\text{s}$ | 1  |
| $t_{pgm4}$                   | “程序长字”执行时间              | —   | 65  | 145 | $\mu\text{s}$ | —  |
| $t_{er\text{sscr}}$          | “擦除 Flash 扇区”执行时间       | —   | 14  | 114 | ms            | 2  |
| $t_{rd1\text{all}}$          | “读 1s 所有块”执行时间          | —   | —   | 0.5 | ms            | —  |
| $t_{rd\text{once}}$          | “读一次”执行时间               | —   | —   | 25  | $\mu\text{s}$ | 1  |
| $t_{pgm\text{once}}$         | “程序运行一次”执行时间            | —   | 65  | —   | $\mu\text{s}$ | —  |
| $t_{er\text{sall}}$          | “擦除所有块”执行时间             | —   | 61  | 500 | ms            | 2  |
| $t_{\text{vfykey}}$          | “验证后门访问密钥”执行时间          | —   | —   | 30  | $\mu\text{s}$ | 1  |

- 假定 Flash 时钟频率为 25 MHz。
- 擦除参数的最大时间，基于循环周期终止时的期望值。

### 3.4.1.3 Flash 高压电流特性

表 26. Flash 高压电流特性

| 符号            | 说明                      | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------|-------------------------|-----|-----|-----|----|
| $I_{DD\_PGM}$ | 高压 Flash 编程操作过程中的平均增加电流 | —   | 2.5 | 6.0 | mA |
| $I_{DD\_ERS}$ | 高压 Flash 擦除操作过程中的平均增加电流 | —   | 1.5 | 4.0 | mA |

### 3.4.1.4 可靠性特性

表 27. NVM 可靠性特性

| 符号                       | 说明                   | 最小值  | 典型值 <sup>1</sup> | 最大值 | 单位 | 注释 |
|--------------------------|----------------------|------|------------------|-----|----|----|
| 程序 Flash                 |                      |      |                  |     |    |    |
| $t_{\text{nv mretp10k}}$ | 高达 10000 个周期后的数据保留时间 | 5    | 50               | —   | 年  | —  |
| $t_{\text{nv mretp1k}}$  | 高达 1000 个周期后的数据保留时间  | 20   | 100              | —   | 年  | —  |
| $n_{\text{nv mcycp}}$    | 周期寿命                 | 10 K | 50 K             | —   | 周期 | 2  |

1. 典型数据保留值基于加速高温和 25 °C 恒温用例情况下所测得的响应。此项技术不适用工程通告 EB618。工程通告 EB619 中定义的典型耐受能力。
2. 擦写耐受能力表示 -40 °C ≤ T<sub>j</sub> ≤ 125 °C 温度范围内的编程/擦除次数。

## 3.5 安全性和完整性模块

对于器件的安全性和完整性模块，无特性要求。

## 3.6 模拟

### 3.6.1 ADC 电气特性

所有 ADC 通道满足 12 位单端精度特性。

#### 3.6.1.1 12 位 ADC 操作条件

表 28. 12 位 ADC 操作条件

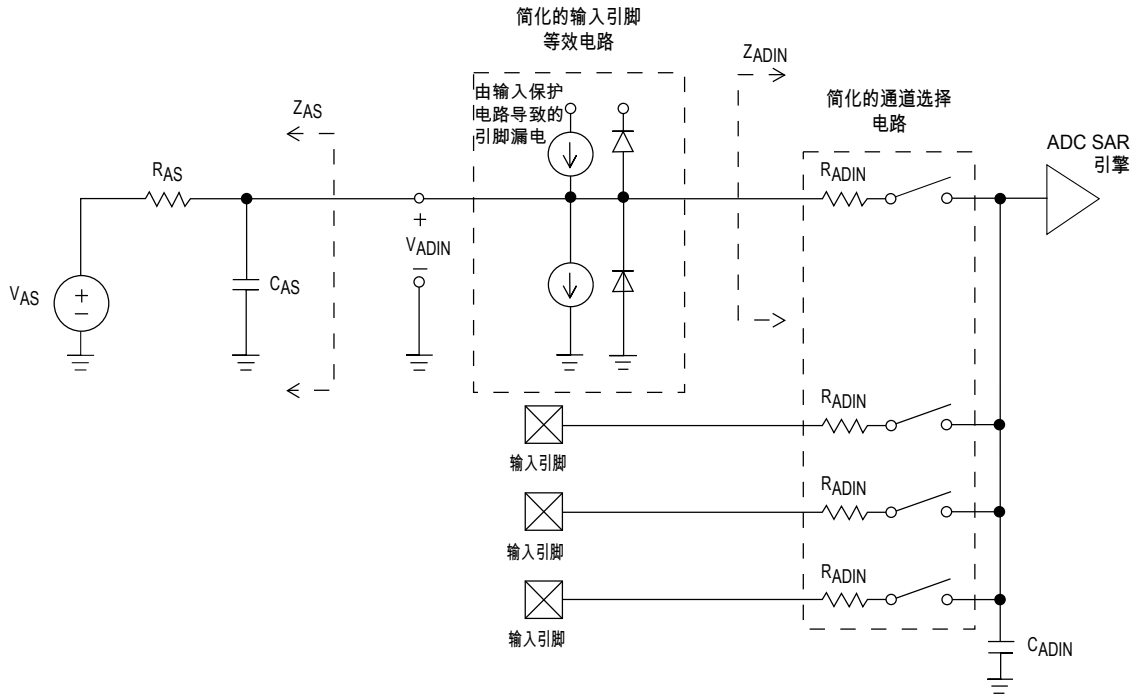
| 符号                | 描述         | 条件   | 最小值               | 典型值 <sup>1</sup> | 最大值               | 单位 | 注释 |
|-------------------|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----|----|
| V <sub>DDA</sub>  | 供电电压       | 绝对值  | 1.71              | —                | 3.6               | V  | —  |
| ΔV <sub>DDA</sub> | 供电电压       | V <sub>DD</sub> 的差值(V <sub>DD</sub> - V <sub>DDA</sub> ) | -100              | 0                | +100              | mV | 2  |
| ΔV <sub>SSA</sub> | 接地电压       | V <sub>SS</sub> 的差值(V <sub>SS</sub> -V <sub>SSA</sub> )  | -100              | 0                | +100              | mV | 2  |
| V <sub>REFH</sub> | ADC 高参考电压  |  | 1.13              | V <sub>DDA</sub> | V <sub>DDA</sub>  | V  | 3  |
| V <sub>REFL</sub> | ADC 低参考电压  |  | V <sub>SSA</sub>  | V <sub>SSA</sub> | V <sub>SSA</sub>  | V  | 3  |
| V <sub>ADIN</sub> | 输入电压       |  | V <sub>REFL</sub> | —                | V <sub>REFH</sub> | V  | —  |
| C <sub>ADIN</sub> | 输入电容       | • 8 位/10 位/12 位模式  | —                 | 4                | 5                 | pF | —  |
| R <sub>ADIN</sub> | 输入串联电阻     |  | —                 | 2                | 5                 | kΩ | —  |
| R <sub>AS</sub>   | 模拟源电阻 (外部) | 12 位模式<br>f <sub>ADCK</sub> < 4 MHz                      | —                 | —                | 5                 | kΩ | 4  |

下一页继续介绍此表...

**表 28. 12 位 ADC 操作条件 (继续)**

| 符号         | 描述         | 条件  | 最小值    | 典型值 <sup>1</sup> | 最大值     | 单位   | 注释 |
|------------|------------|---|--------|------------------|---------|------|----|
| $f_{ADCK}$ | ADC 转换时钟频率 | ≤ 12 位模式                                    | 1.0    | —                | 18.0    | MHz  | 5  |
| $C_{rate}$ | ADC 转换速率   | ≤ 12 位模式<br>无 ADC 硬件平均值<br>连续转换功能使能, 后续转换时间 | 20.000 | —                | 818.330 | Ksps | 6  |

1. 除非另有说明, 否则典型值假定  $V_{DDA} = 3.0\text{ V}$ ,  $\text{Temp} = 25^\circ\text{C}$ ,  $f_{ADCK} = 1.0\text{ MHz}$ 。典型值仅供参考, 并未在生产中进行测试。
2. 直流电位差。
3. 在没有专用  $V_{REFH}$  和  $V_{REFL}$  引脚的封装中,  $V_{REFH}$  内部连接到  $V_{DDA}$  上, 而  $V_{REFL}$  内部连接到  $V_{SSA}$  上。
4. 此电阻是 MCU 的外部电阻。为达到最佳效果, 模拟源电阻必须尽量小一些。此数据手册中的结果来自于模拟源电阻  $< 8\ \Omega$  的系统。 $R_{AS}/C_{AS}$  时间常数应当始终  $< 1\text{ ns}$ 。
5. 要使用最大 ADC 转换时钟频率, 必须使  $\text{CFG2}[\text{ADHSC}]$  置位, 并使  $\text{CFG1}[\text{ADLPC}]$  清零。
6. 有关计算转换速率的相应准则和示例, 请下载 [ADC 计算器工具](#)。


**图 8. ADC 输入阻抗等效图**

### 3.6.1.2 12 位 ADC 电气特性



**表 29. 12 位 ADC 特性( $V_{REFH} = V_{DDA}$ ,  $V_{REFL} = V_{SSA}$ )**

| 符号             | 描述        | 条件 <sup>1</sup>        | 最小值                    | 典型值 <sup>2</sup> | 最大值         | 单位               | 注释                                   |   |
|----------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|---|
| $I_{DDA\_ADC}$ | 供电电流      |                        | 0.215                  | —                | 1.7         | mA               | 3                                    |   |
| $f_{ADACK}$    | ADC 异步时钟源 | • ADLPC = 1, ADHSC = 0 | 1.2                    | 2.4              | 3.9         | MHz              | $t_{ADACK} = 1/f_{ADACK}$            |   |
|                |           | • ADLPC = 1, ADHSC = 1 | 2.4                    | 4.0              | 6.1         | MHz              |                                      |   |
|                |           | • ADLPC = 0, ADHSC = 0 | 3.0                    | 5.2              | 7.3         | MHz              |                                      |   |
|                |           | • ADLPC = 0, ADHSC = 1 | 4.4                    | 6.2              | 9.5         | MHz              |                                      |   |
|                | 采样时间      | 参见“参考手册”一章确定采样时间       |                        |                  |             |                  |                                      |   |
| TUE            | 未调整总误差    | • 12 位模式               | —                      | ±6               | —           | LSB <sup>4</sup> | 5                                    |   |
|                |           | • <12 位模式              | —                      | ±3               | ±6          |                  |                                      |   |
| DNL            | 差分非线性     | • 12 位模式               | —                      | ±0.9             | -1.1 到 +1.9 | LSB <sup>4</sup> | 5                                    |   |
|                |           | • <12 位模式              | —                      | ±0.4             | -0.3 到 +0.5 |                  |                                      |   |
| INL            | 积分非线性     | • 12 位模式               | —                      | ±1.5             | -2.7 到 +1.9 | LSB <sup>4</sup> | 5                                    |   |
|                |           | • <12 位模式              | —                      | ±0.5             | -0.7 到 +0.5 |                  |                                      |   |
| $E_{FS}$       | 满量程误差     | • 12 位模式               | —                      | 5                | —           | LSB <sup>4</sup> | $V_{ADIN} = V_{DDA}$ <sup>5</sup>    |   |
|                |           | • <12 位模式              | —                      | 2                | 3           |                  |                                      |   |
| $E_Q$          | 量化误差      | • 12 位模式               | —                      | —                | ±0.5        | LSB <sup>4</sup> |                                      |   |
| $E_{IL}$       | 输入漏电误差    |                        | $I_{in} \times R_{AS}$ |                  |             | mV               | $I_{in}$ = 漏电流<br>(参见 MCU 电压和电流操作极限) |   |
|                | 温度传感器斜率   | 横跨设备整个温度范围             |                        | 1.55             | 1.62        | 1.69             | mV/°C                                | 6 |
| $V_{TEMP25}$   | 温度传感器电压   | 25 °C                  | 706                    | 716              | 726         | mV               | 6                                    |   |

1. 所有精度数字均假定 ADC 已在  $V_{REFH} = V_{DDA}$  的情况下进行校准
2. 除非另有说明, 否则典型值假定  $V_{DDA} = 3.0$  V、Temp = 25°C、 $f_{ADCK} = 2.0$  MHz。典型值仅供参考, 并未在生产中进行测试。
3. ADC 供电电流取决于 ADC 转换时钟速度、转换速率以及 ADC\_CFG1[ADLPC] (低功耗)。要使操作功耗最低, ADC\_CFG1[ADLPC]必须置位, ADC\_CFG2[ADHSC]位必须清零, 且 ADC 转换时钟速度为 1 MHz。
4.  $1 \text{ LSB} = (V_{REFH} - V_{REFL})/2^N$
5. ADC 转换时钟 < 16 MHz, 最大硬件平均值(AVGE = %1, AVGS = %11)
6. ADC 转换时钟 < 3 MHz

**表 30. 12 位 ADC 特性( $V_{REFH} = V_{REFO}$ ,  $V_{REFL} = V_{SSA}$ )**

| 符号             | 描述   | 条件 <sup>1</sup> | 最小值   | 典型值 <sup>2</sup> | 最大值 | 单位 | 注释 |
|----------------|------|-----------------|-------|------------------|-----|----|----|
| $I_{DDA\_ADC}$ | 供电电流 |                 | 0.215 | —                | 1.7 | mA | 3  |

下一页继续介绍此表...

**表 30. 12 位 ADC 特性( $V_{REFH} = V_{REFO}$ ,  $V_{REFL} = V_{SSA}$ ) (继续)**

| 符号           | 描述        | 条件 <sup>1</sup>        | 最小值                    | 典型值 <sup>2</sup> | 最大值         | 单位               | 注释                                   |
|--------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| $f_{ADACK}$  | ADC 异步时钟源 | • ADLPC = 1, ADHSC = 0 | 1.2                    | 2.4              | 3.9         | MHz              | $t_{ADACK} = 1/f_{ADACK}$            |
|              |           | • ADLPC = 1, ADHSC = 1 | 2.4                    | 4.0              | 6.1         | MHz              |                                      |
|              |           | • ADLPC = 0, ADHSC = 0 | 3.0                    | 5.2              | 7.3         | MHz              |                                      |
|              |           | • ADLPC = 0, ADHSC = 1 | 4.4                    | 6.2              | 9.5         | MHz              |                                      |
|              | 采样时间      | 参见“参考手册”一章确定采样时间       |                        |                  |             |                  |                                      |
| TUE          | 未调整总误差    | • 12 位模式               | —                      | ±4               | ±6.8        | LSB <sup>4</sup> | 5                                    |
|              |           | • <12 位模式              | —                      | ±1.4             | ±2.1        |                  |                                      |
| DNL          | 差分非线性     | • 12 位模式               | —                      | ±0.7             | -1.1 到 +1.9 | LSB <sup>4</sup> | 5                                    |
|              |           | • <12 位模式              | —                      | ±0.2             | -0.3 到 +0.5 |                  |                                      |
| INL          | 积分非线性     | • 12 位模式               | —                      | ±1.0             | -2.7 到 +1.9 | LSB <sup>4</sup> | 5                                    |
|              |           | • <12 位模式              | —                      | ±0.5             | -0.7 到 +0.5 |                  |                                      |
| $E_{FS}$     | 满量程误差     | • 12 位模式               | —                      | -4               | -5.4        | LSB <sup>4</sup> | $V_{ADIN} = V_{DDA}$ <sup>5</sup>    |
|              |           | • <12 位模式              | —                      | -1.4             | -1.8        |                  |                                      |
| $E_Q$        | 量化误差      | • 12 位模式               | —                      | —                | ±0.5        | LSB <sup>4</sup> |                                      |
| $E_{IL}$     | 输入漏电误差    |                        | $I_{in} \times R_{AS}$ |                  |             | mV               | $I_{in}$ = 漏电流<br>(参见 MCU 电压和电流操作极限) |
|              | 温度传感器斜率   | 横跨设备整个温度范围             | 1.55                   | 1.62             | 1.69        | mV/°C            | 6                                    |
| $V_{TEMP25}$ | 温度传感器电压   | 25 °C                  | 706                    | 716              | 726         | mV               | 6                                    |

1. 所有精度数字均假定 ADC 已在  $V_{REFH} = V_{REFO}$  的情况下进行校准
2. 除非另有说明, 否则典型值假定  $V_{REFO} = 3.0\text{ V}$ 、 $\text{Temp} = 25^\circ\text{C}$ 、 $f_{ADCK} = 2.0\text{ MHz}$ 。典型值仅供参考, 并未在生产中进行测试。
3. ADC 供电电流取决于 ADC 转换时钟速度、转换速率以及 ADC\_CFG1[ADLPC] (低功耗)。要使操作功耗最低, ADC\_CFG1[ADLPC] 必须置位, ADC\_CFG2[ADHSC] 位必须清零, 且 ADC 转换时钟速度为 1 MHz。
4.  $1\text{ LSB} = (V_{REFH} - V_{REFL})/2^N$
5. ADC 转换时钟 < 16 MHz, 最大硬件平均值(AVGE = %1, AVGS = %11)
6. ADC 转换时钟 < 3 MHz

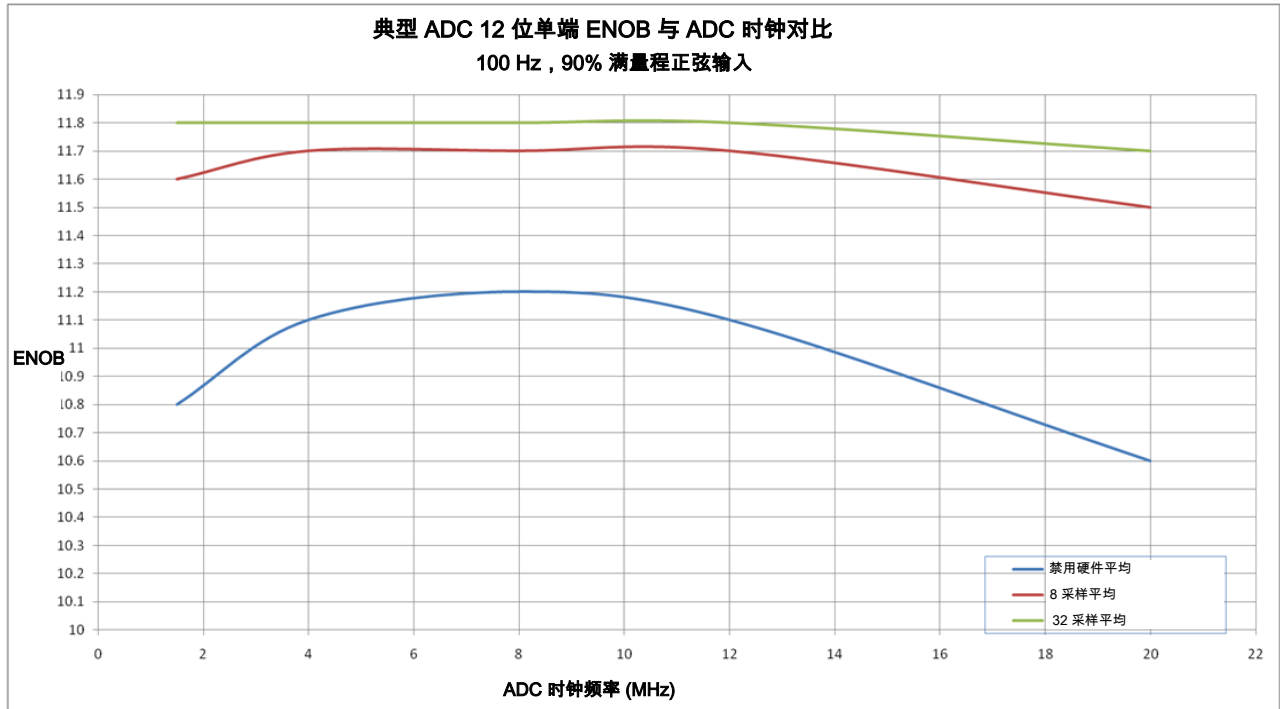


图 9. 典型 ENOB 与 ADC\_CLK, 12 位单端模式

### 3.6.2 CMP 和 6 位 DAC 的电气特性

表 31. 比较器和 6 位 DAC 的电气特性

| 符号          | 说明  | 最小值            | 典型值                 | 最大值      | 单位      |
|-------------|---|----------------|---------------------|----------|---------|
| $V_{DD}$    | 供电电压  | 1.71           | —                   | 3.6      | V       |
| $I_{DDHS}$  | 供电电流, 高速模式 (EN=1, PMODE=1)  | —              | —                   | 200      | $\mu A$ |
| $I_{DDL5}$  | 供电电流, 低速模式 (EN=1, PMODE=0)  | —              | —                   | 20       | $\mu A$ |
| $V_{AIN}$   | 模拟输入电压  | $V_{SS} - 0.3$ | —                   | $V_{DD}$ | V       |
| $V_{AIO}$   | 模拟输入偏移电压  | —              | —                   | 20       | mV      |
| $V_H$       | 模拟比较器迟滞 <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CR0[HYSTCTR] = 00</li> <li>• CR0[HYSTCTR] = 01</li> <li>• CR0[HYSTCTR] = 10</li> <li>• CR0[HYSTCTR] = 11</li> </ul> | —              | 5<br>10<br>20<br>30 | —        | mV      |
| $V_{CMPOh}$ | 输出高电平   | $V_{DD} - 0.5$ | —                   | —        | V       |
| $V_{CMPOl}$ | 输出低电平   | —              | —                   | 0.5      | V       |
| $t_{DHS}$   | 传播延迟, 高速模式 (EN=1, PMODE=1)  | 20             | 50                  | 200      | ns      |

下一页继续介绍此表...

表 31. 比较器和 6 位 DAC 的电气特性 (继续)

| 符号          | 说明                         | 最小值  | 典型值 | 最大值 | 单位               |
|-------------|----------------------------|------|-----|-----|------------------|
| $t_{DLS}$   | 传播延迟, 低速模式 (EN=1, PMODE=0) | 80   | 250 | 600 | ns               |
|             | 模拟比较器初始化延迟 <sup>2</sup>    | —    | —   | 40  | $\mu$ s          |
| $I_{DAC6b}$ | 6 位 DAC 增加电流 (使能)          | —    | 7   | —   | $\mu$ A          |
| INL         | 6 位 DAC 积分非线性              | -0.5 | —   | 0.5 | LSB <sup>3</sup> |
| DNL         | 6 位 DAC 差分非线性              | -0.3 | —   | 0.3 | LSB              |

1. 在输入电压范围限定为 0.6 至  $V_{DD}-0.6$  V 的条件下测定典型迟滞。
2. 比较器初始化延迟定义为从软件执行写操作来改变控制输入 ( 写入 CMP\_DACCR[DACEN]、CMP\_DACCR[VRSEL]、CMP\_DACCR[VOSEL]、CMP\_MUXCR[PSEL]和 CMP\_MUXCR[MSEL] ) 到比较器输出达到稳定电平的时间。
3.  $1 \text{ LSB} = V_{\text{reference}}/64$

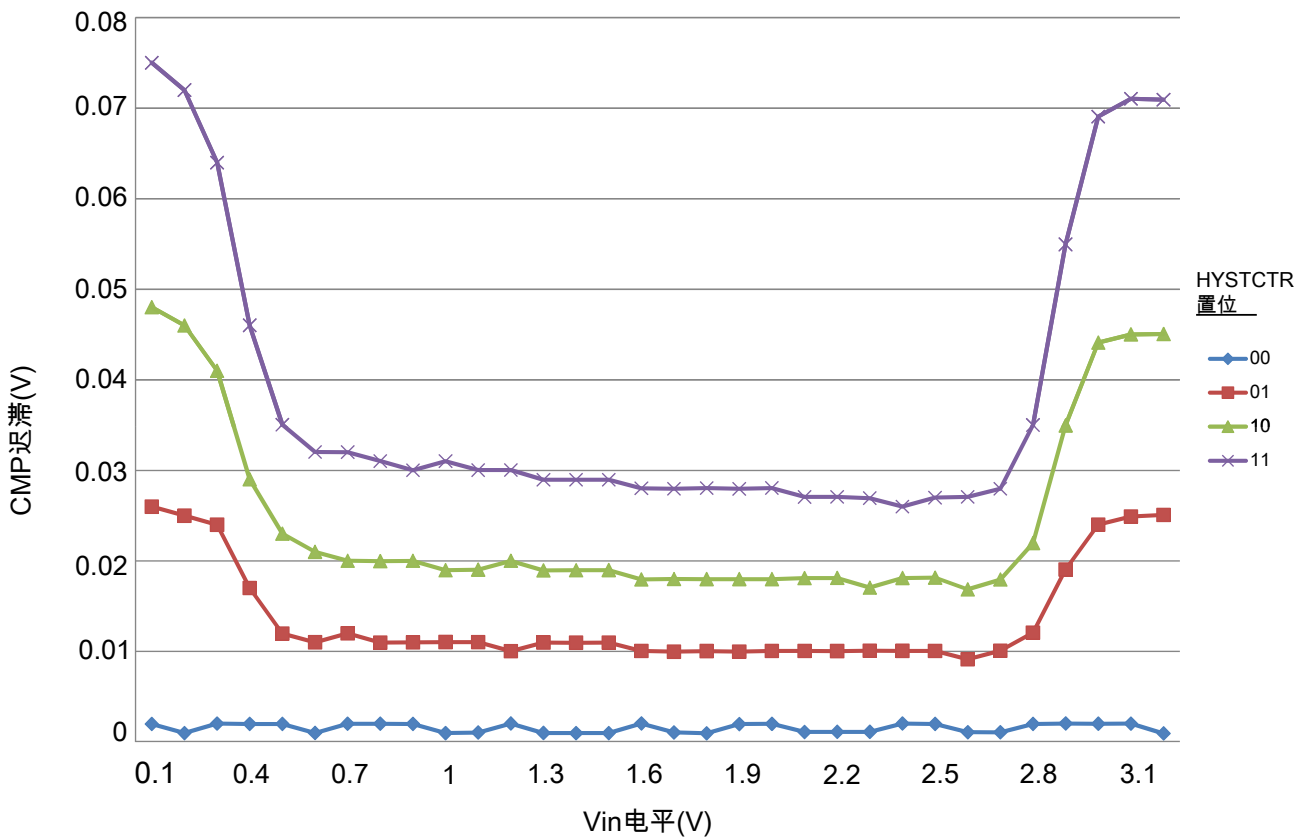


图 10. 典型迟滞与 Vin 电平 (VDD = 3.3 V, PMODE = 0)

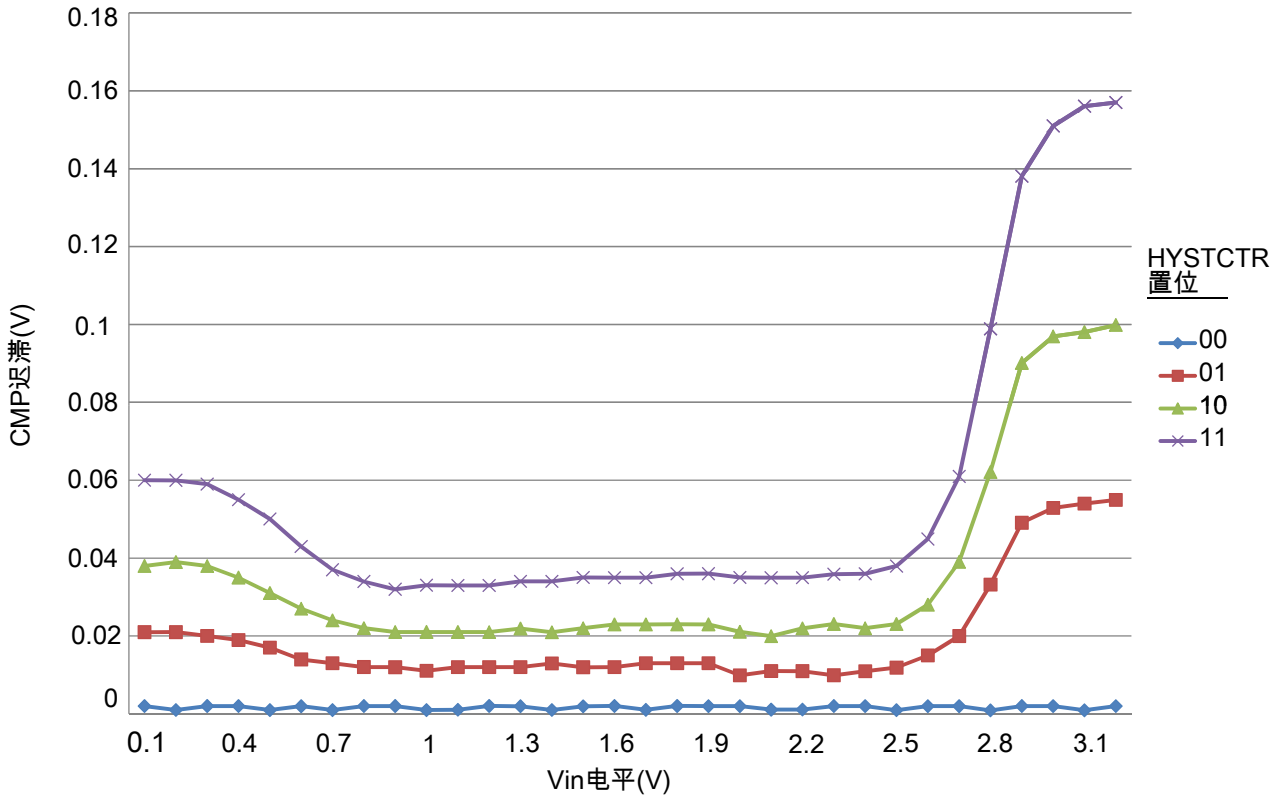


图 11. 典型迟滞与 Vin 电平(VDD = 3.3 V, PMODE = 1)

### 3.6.3 电压基准电气特性

表 32. VREF 全范围工作条件

| 符号               | 说明     | 最小值       | 最大值 | 单位 | 注释   |
|------------------|--------|-----------|-----|----|------|
| V <sub>DDA</sub> | 供电电压   | 1.71      | 3.6 | V  | —    |
| T <sub>A</sub>   | 温度     | 器件的工作温度范围 |     | °C | —    |
| C <sub>L</sub>   | 输出负载电容 | 100       |     | nF | 1, 2 |

1. 如果使用 VREF\_OUT 作为内部或外部参考电压，则 C<sub>L</sub> 必须连接至 VREF\_OUT。
2. 负载电容应不超过该器件工作温度范围内指定 C<sub>L</sub> 标称值的 +/-25%。

表 33 的测试条件为 VREF\_TRM[CHOPEN]、VREF\_SC[REGEN]和 VREF\_SC[ICOMPEN]位设为 1。

**表 33. VREF 全范围特性**

| 符号                | 说明  | 最小值    | 典型值   | 最大值    | 单位    | 注释   |
|-------------------|---|--------|-------|--------|-------|------|
| $V_{out}$         | 在标称 $V_{DDA}$ 和 25°C 温度下, 出厂前调整的电压基准输出        | 1.1915 | 1.195 | 1.1977 | V     | 1    |
| $V_{out}$         | 出厂前调整的电压基准输出                                  | 1.1584 | —     | 1.2376 | V     | 1    |
| $V_{out}$         | 用户调整的电压基准输出                                   | 1.193  | —     | 1.197  | V     | 1    |
| $V_{step}$        | 电压基准微调量                                       | —      | 0.5   | —      | mV    | 1    |
| $V_{tdrift}$      | 温度漂移 (全温度范围 0 至 70°C 内的 $V_{max} - V_{min}$ ) | —      | —     | 50     | mV    | 1    |
| Ac                | 老化系数  | —      | —     | 400    | uV/yr | —    |
| $I_{bg}$          | 仅带隙电流   | —      | —     | 80     | μA    | 1    |
| $I_{lp}$          | 低功率缓冲器电流                                      | —      | —     | 360    | uA    | 1    |
| $I_{hp}$          | 高功率缓冲器电流                                      | —      | —     | 1      | mA    | 1    |
| $\Delta V_{LOAD}$ | 负载调节<br>• 电流 = $\pm 1.0$ mA                   | —      | 200   | —      | μV    | 1, 2 |
| $T_{stup}$        | 缓冲器启动时间                                       | —      | —     | 100    | μs    | —    |
| $V_{vdrift}$      | 电压漂移 (全电压范围内的 $V_{max} - V_{min}$ )           | —      | 2     | —      | mV    | 1    |

1. 关于 VREF 状态和控制寄存器的正确设置, 请查看芯片的参考手册。
2. 负载调节电压是空载 VREF\_OUT 电压和带特定负载的 VREF\_OUT 电压之间的差值。

**表 34. VREF 窄范围工作条件**

| 符号    | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 注释 |
|-------|----|-----|-----|----|----|
| $T_A$ | 温度 | 0   | 50  | °C | —  |

**表 35. VREF 窄范围特性**

| 符号        | 说明           | 最小值   | 最大值   | 单位 | 注释 |
|-----------|--------------|-------|-------|----|----|
| $V_{out}$ | 出厂前调整的电压基准输出 | 1.173 | 1.225 | V  | —  |

## 3.7 定时器

参见 [一般开关规格](#)。

## 3.8 通信接口

### 3.8.1 SPI 电气及时序特性

串行外设接口(SPI)提供一种可实现主机和从机工作模式的同步串行总线。多数传输特性都是可编程的。下列表格提供了传统 SPI 时序模式的时序特性。如需了解与较慢的外设器件通信所用的可编程的传输属性,请参见芯片参考手册中的 SPI 章节。

除非另有说明,显示的所有时序相关条件均为 20%  $V_{DD}$  和 80%  $V_{DD}$  阈值,同时所有 SPI 引脚上的输入信号转换均为 3 ns,最大负载均为 30 pF。

表 36. SPI 主机模式时序 - 管脚禁用压摆率

| 编号 | 符号           | 说明                 | 最小值                   | 最大值                      | 单位          | 注释 |
|----|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----|
| 1  | $f_{op}$     | 工作频率               | $f_{periph}/2048$     | $f_{periph}/2$           | Hz          | 1  |
| 2  | $t_{SPSCK}$  | SPSCK 周期           | $2 \times t_{periph}$ | $2048 \times t_{periph}$ | ns          | 2  |
| 3  | $t_{Lead}$   | 启用前置时间             | 1/2                   | —                        | $t_{SPSCK}$ | —  |
| 4  | $t_{Lag}$    | 启用滞后时间             | 1/2                   | —                        | $t_{SPSCK}$ | —  |
| 5  | $t_{WSPSCK}$ | 时钟(SPSCK)高电平或低电平时间 | $t_{periph} - 30$     | $1024 \times t_{periph}$ | ns          | —  |
| 6  | $t_{SU}$     | 数据建立时间 (输入)        | 22                    | —                        | ns          | —  |
| 7  | $t_{HI}$     | 数据保持时间 (输入)        | 0                     | —                        | ns          | —  |
| 8  | $t_v$        | 有效数据 (在 SPSCK 边沿后) | —                     | 10                       | ns          | —  |
| 9  | $t_{HO}$     | 数据保持时间 (输出)        | 0                     | —                        | ns          | —  |
| 10 | $t_{RI}$     | 输入上升时间             | —                     | $t_{periph} - 25$        | ns          | —  |
|    | $t_{FI}$     | 输入下降时间             |                       |                          |             |    |
| 11 | $t_{RO}$     | 输出上升时间             | —                     | 25                       | ns          | —  |
|    | $t_{FO}$     | 输出下降时间             |                       |                          |             |    |

1. 对于 SPI0,  $f_{periph}$  用作总线时钟( $f_{BUS}$ )。
2.  $t_{periph} = 1/f_{periph}$

表 37. SPI 主机模式时序--管脚使能压摆率

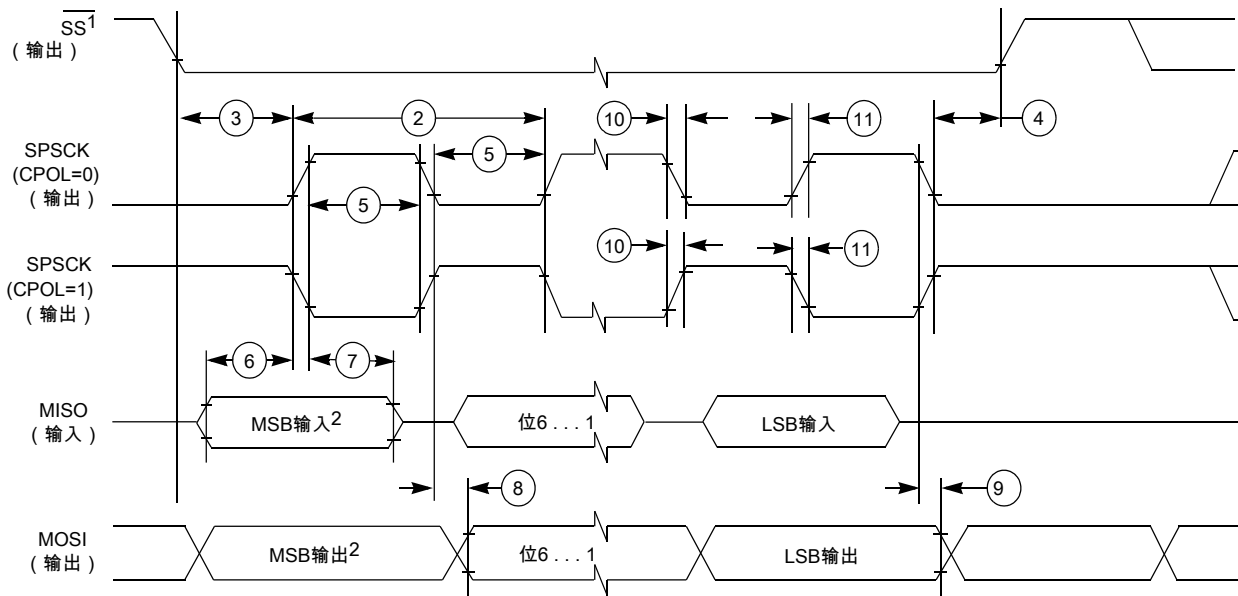
| 编号 | 符号           | 说明                 | 最小值                   | 最大值                      | 单位          | 注释 |
|----|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----|
| 1  | $f_{op}$     | 工作频率               | $f_{periph}/2048$     | $f_{periph}/2$           | Hz          | 1  |
| 2  | $t_{SPSCK}$  | SPSCK 周期           | $2 \times t_{periph}$ | $2048 \times t_{periph}$ | ns          | 2  |
| 3  | $t_{Lead}$   | 启用前置时间             | 1/2                   | —                        | $t_{SPSCK}$ | —  |
| 4  | $t_{Lag}$    | 启用滞后时间             | 1/2                   | —                        | $t_{SPSCK}$ | —  |
| 5  | $t_{WSPSCK}$ | 时钟(SPSCK)高电平或低电平时间 | $t_{periph} - 30$     | $1024 \times t_{periph}$ | ns          | —  |

下一页继续介绍此表...

表 37. SPI 主机模式时序--管脚使能压摆率 (继续)

| 编号 | 符号       | 说明                  | 最小值 | 最大值               | 单位 | 注释 |
|----|----------|---------------------|-----|-------------------|----|----|
| 6  | $t_{SU}$ | 数据建立时间 (输入)         | 96  | —                 | ns | —  |
| 7  | $t_{HI}$ | 数据保持时间 (输入)         | 0   | —                 | ns | —  |
| 8  | $t_V$    | 有效数据 (在 SPSCCK 边沿后) | —   | 52                | ns | —  |
| 9  | $t_{HO}$ | 数据保持时间 (输出)         | 0   | —                 | ns | —  |
| 10 | $t_{RI}$ | 输入上升时间              | —   | $t_{periph} - 25$ | ns | —  |
|    | $t_{FI}$ | 输入下降时间              | —   |                   |    |    |
| 11 | $t_{RO}$ | 输出上升时间              | —   | 36                | ns | —  |
|    | $t_{FO}$ | 输出下降时间              | —   |                   |    |    |

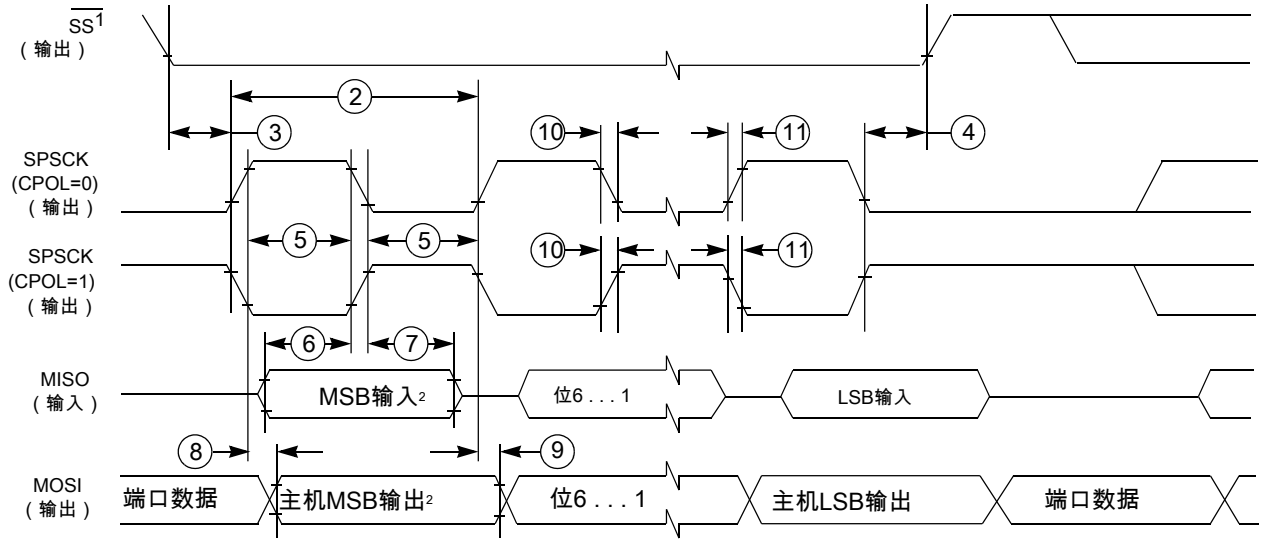
1. 对于 SPI0,  $f_{periph}$  用作总线时钟( $f_{BUS}$ )。
2.  $t_{periph} = 1/f_{periph}$



1. 如果配置为输出。
2. LSBF = 0。对于LSBF = 1, 位序为LSB、位1、...、位6、MSB。

图 12. SPI 主机模式时序(CPHA = 0)





1. 如果配置为输出。
2. LSBF = 0。对于LSBF = 1，位序为LSB、位1、...、位6、MSB。

**图 13. SPI 主机模式时序(CPHA = 1)**
**表 38. SPI 从机模式时序 - 管脚禁用压摆率**

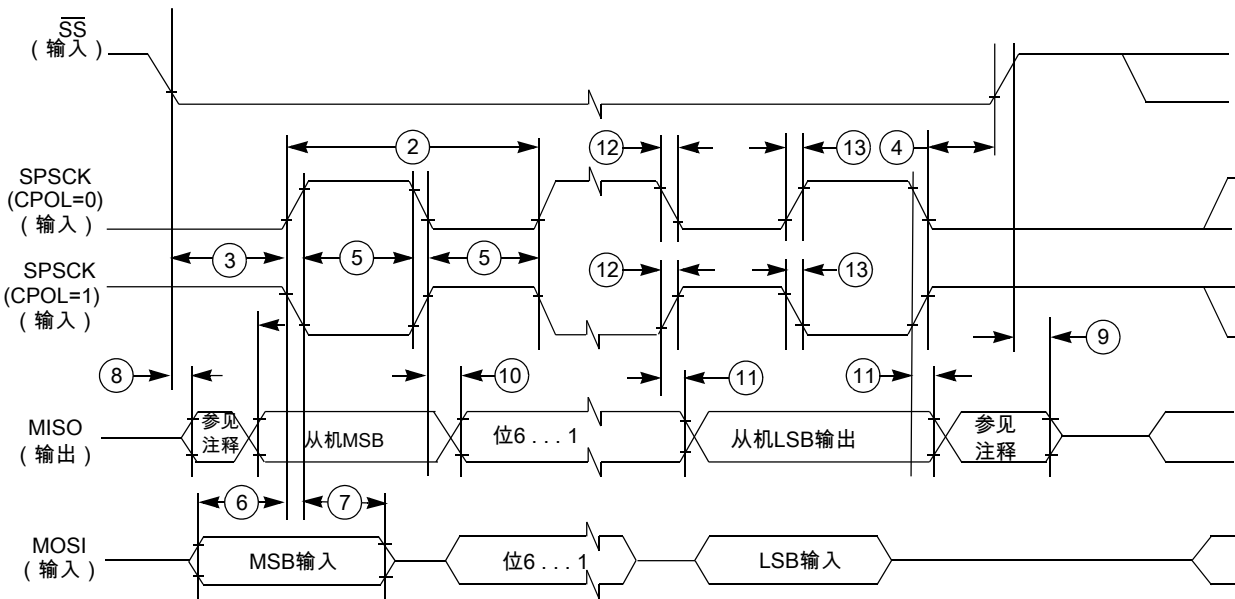
| 编号 | 符号            | 说明                  | 最小值                   | 最大值               | 单位           | 注释 |
|----|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----|
| 1  | $f_{op}$      | 操作频率                | 0                     | $f_{periph}/4$    | Hz           | 1  |
| 2  | $t_{SPSCCK}$  | SPSCCK 周期           | $4 \times t_{periph}$ | —                 | ns           | 2  |
| 3  | $t_{Lead}$    | 启用前置时间              | 1                     | —                 | $t_{periph}$ | —  |
| 4  | $t_{Lag}$     | 启用滞后时间              | 1                     | —                 | $t_{periph}$ | —  |
| 5  | $t_{WSPSCCK}$ | 时钟(SPSCCK)高电平或低电平时间 | $t_{periph} - 30$     | —                 | ns           | —  |
| 6  | $t_{SU}$      | 数据建立时间 (输入)         | 3                     | —                 | ns           | —  |
| 7  | $t_{HI}$      | 数据保持时间 (输入)         | 7                     | —                 | ns           | —  |
| 8  | $t_a$         | 从机访问时间              | 23                    | $t_{periph}$      | ns           | 3  |
| 9  | $t_{dis}$     | 从机 MISO 禁用时间        | 23                    | $t_{periph}$      | ns           | 4  |
| 10 | $t_v$         | 有效数据 (在 SPSCCK 边沿后) | —                     | 25.7              | ns           | —  |
| 11 | $t_{HO}$      | 数据保持时间 (输出)         | 0                     | —                 | ns           | —  |
| 12 | $t_{RI}$      | 输入上升时间              | —                     | $t_{periph} - 25$ | ns           | —  |
|    | $t_{FI}$      | 输入下降时间              |                       |                   |              |    |
| 13 | $t_{RO}$      | 输出上升时间              | —                     | 25                | ns           | —  |
|    | $t_{FO}$      | 输出下降时间              |                       |                   |              |    |

1. 对于 SPI0， $f_{periph}$  用作总线时钟( $f_{BUS}$ )。
2.  $t_{periph} = 1/f_{periph}$
3. 从高阻抗状态到数据有效的的时间
4. 到高阻抗状态的保持时间

**表 39. SPI 从机模式时序--管脚使能压摆率**

| 编号 | 符号           | 说明                 | 最小值                   | 最大值               | 单位           | 注释 |
|----|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----|
| 1  | $f_{op}$     | 操作频率               | 0                     | $f_{periph}/4$    | Hz           | 1  |
| 2  | $t_{SPSCK}$  | SPSCK 周期           | $4 \times t_{periph}$ | —                 | ns           | 2  |
| 3  | $t_{Lead}$   | 启用前置时间             | 1                     | —                 | $t_{periph}$ | —  |
| 4  | $t_{Lag}$    | 启用滞后时间             | 1                     | —                 | $t_{periph}$ | —  |
| 5  | $t_{WSPSCK}$ | 时钟(SPSCK)高电平或低电平时间 | $t_{periph} - 30$     | —                 | ns           | —  |
| 6  | $t_{SU}$     | 数据建立时间 (输入)        | 2                     | —                 | ns           | —  |
| 7  | $t_{HI}$     | 数据保持时间 (输入)        | 7                     | —                 | ns           | —  |
| 8  | $t_a$        | 从机访问时间             | —                     | $t_{periph}$      | ns           | 3  |
| 9  | $t_{dis}$    | 从机 MISO 禁用时间       | —                     | $t_{periph}$      | ns           | 4  |
| 10 | $t_v$        | 有效数据 (在 SPSCK 边沿后) | —                     | 122               | ns           | —  |
| 11 | $t_{HO}$     | 数据保持时间 (输出)        | 0                     | —                 | ns           | —  |
| 12 | $t_{RI}$     | 输入上升时间             | —                     | $t_{periph} - 25$ | ns           | —  |
|    | $t_{FI}$     | 输入下降时间             |                       |                   |              |    |
| 13 | $t_{RO}$     | 输出上升时间             | —                     | 36                | ns           | —  |
|    | $t_{FO}$     | 输出下降时间             |                       |                   |              |    |

1. 对于 SPI0,  $f_{periph}$  用作总线时钟( $f_{BUS}$ )。
2.  $t_{periph} = 1/f_{periph}$
3. 从高阻抗状态到数据有效的的时间
4. 到高阻抗状态的保持时间



注释：未定义

**图 14. SPI 从机模式时序(CPHA = 0)**

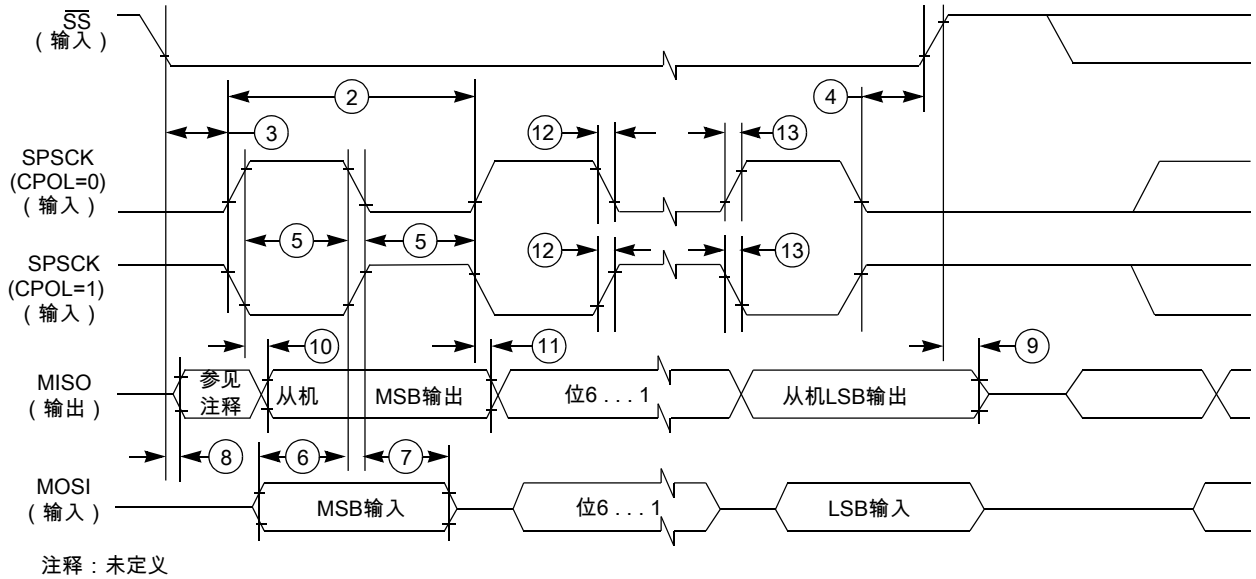


图 15. SPI 从机模式时序(CPHA = 1)

### 3.8.2 内部集成电路接口(I2C)时序

表 40. I2C 时序

| 特性                              | 符号            | 标准模式             |                   | 快速模式 <sup>1</sup>          |                  | 单位      |
|---------------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------|
|                                 |               | 最小值              | 最大值               | 最小值                        | 最大值              |         |
| SCL 时钟频率                        | $f_{SCL}$     | 0                | 100               | 0                          | 400 <sup>2</sup> | kHz     |
| 重复 START 条件的保持时间。此周期后生成第一个时钟脉冲。 | $t_{HD}; STA$ | 4                | —                 | 0.6                        | —                | $\mu s$ |
| SCL 时钟的 LOW 周期                  | $t_{LOW}$     | 4.7              | —                 | 1.3                        | —                | $\mu s$ |
| SCL 时钟的 HIGH 周期                 | $t_{HIGH}$    | 4                | —                 | 0.6                        | —                | $\mu s$ |
| 重复 START 条件的建立时间                | $t_{SU}; STA$ | 4.7              | —                 | 0.6                        | —                | $\mu s$ |
| I <sup>2</sup> C 总线器件的数据保持时间    | $t_{HD}; DAT$ | 0 <sup>3</sup>   | 3.45 <sup>4</sup> | 0 <sup>5</sup>             | 0.9 <sup>3</sup> | $\mu s$ |
| 数据建立时间                          | $t_{SU}; DAT$ | 250 <sup>6</sup> | —                 | 100 <sup>4,7</sup>         | —                | ns      |
| SDA 和 SCL 信号的上升时间               | $t_r$         | —                | 1000              | $20 + 0.1C_b$ <sup>8</sup> | 300              | ns      |
| SDA 和 SCL 信号的下降时间               | $t_f$         | —                | 300               | $20 + 0.1C_b$ <sup>7</sup> | 300              | ns      |
| STOP 条件的建立时间                    | $t_{SU}; STO$ | 4                | —                 | 0.6                        | —                | $\mu s$ |
| STOP 和 START 条件之间的总线空闲时间        | $t_{BUF}$     | 4.7              | —                 | 1.3                        | —                | $\mu s$ |
| 输入滤波器必须抑制的尖峰脉宽                  | $t_{SP}$      | N/A              | N/A               | 0                          | 50               | ns      |

1.  $V_{DD} > 2.7 V$  时, 所有引脚均支持快速模式。如果  $V_{DD} < 2.7 V$ , 则只有支持高驱动强度的引脚才支持采用最大总线负载的快速模式。
2. 在采用最大总线负载的快速模式下, 仅当使用高电流驱动引脚( 参见 [电压和电流特性](#) )或使用正常驱动引脚且  $V_{DD} \geq 2.7 V$  时, 才能获得最高 SCL 时钟频率
3. 主机模式 I<sup>2</sup>C 在 SCL 下降沿的同时使地址字节的 ACK 变为无效。如果没有从机应答此地址字节, 则产生负保持时间, 具体取决于 SDA 和 SCL 线的边沿速率。

4. 只有在器件不延长 SCL 信号的 LOW 周期( $t_{LOW}$ )时, 才必须满足最大  $t_{HD}; DAT$ 。
5. 输入信号压摆率 = 10 ns, 输出负载 = 50 pF
6. 如果 TX FIFO 为空, 则从机-发送器模式下的建立时间为 1 个 IPBus 时钟周期。
7. 可在标准模式 I2C 总线系统中使用快速模式 I2C 总线器件, 但此时必须满足  $t_{SU}; DAT \geq 250$  ns 的要求。器件不延长 SCL 信号的 LOW 周期时, 将自动适用该情形。如果此类器件确实延长了 SCL 信号的 LOW 周期, 则它必须在释放 SCL 线之前, 将下一个数据位输出至 SDA 线  $t_{rmax} + t_{SU}; DAT = 1000 + 250 = 1250$  ns ( 根据标准模式 I2C 总线规范 )。
8.  $C_b$  = 一条总线线路的总电容, 单位为 pF。

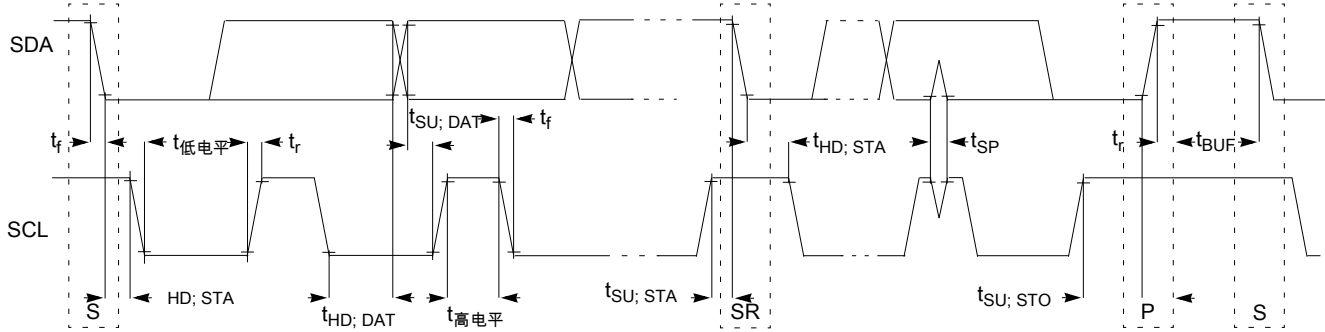


图 16. I<sup>2</sup>C 总线器件上快速和标准模式的时序定义

### 3.8.3 UART

参见一般开关规格。

## 4 尺寸

### 4.1 获取封装尺寸

封装图纸中提供了封装尺寸。

如要查找封装图纸, 敬请前往 [freescale.com](http://freescale.com), 并按关键字搜索封装图纸的文档编号:

| 如果需要此封装的图纸  | 请使用此文档编号    |
|-------------|-------------|
| 16 引脚 QFN   | 98ASA00525D |
| 24 引脚 QFN   | 98ASA00602D |
| 20 引脚 WLCSP | 98ASA00676D |

## 5 引脚分配

### 5.1 KL03 信号多路复用和引脚分配

下表显示的是各引脚上的信号以及这些引脚在本文档中所支持器件上的位置。“端口控制模块”负责选择每个引脚上的 ALT 功能。

#### 注

PTB3 和 PTB4 是真的开漏引脚。使用 I2C、GPIO 和 LPUART0 时，必须增加外部上拉电阻，使其输出正确的值。

| 24 QFN | 20 WLC SP | 16 QFN | Pin Name                       | 默认值                   | ALT0                  | ALT1                           | ALT2       | ALT3       | ALT4       | ALT5   |
|--------|-----------|--------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 1      | —         | —      | PTB6/<br>IRQ_2/<br>LPTMR0_ALT3 | 禁用                    |                       | PTB6/<br>IRQ_2/<br>LPTMR0_ALT3 | TPM1_CH1   | TPM_CLKIN1 |            |        |
| 2      | —         | —      | PTB7/<br>IRQ_3                 | 禁用                    |                       | PTB7/<br>IRQ_3                 | TPM1_CH0   |            |            |        |
| 3      | B5        | 1      | VDD                            | VDD                   | VDD                   |                                |            |            |            |        |
| 4      | C5        | 2      | VSS                            | VSS                   | VSS                   |                                |            |            |            |        |
| 5      | C4        | 3      | PTA3                           | EXTAL0                | EXTAL0                | PTA3                           | I2C0_SCL   | I2C0_SDA   | LPUART0_TX |        |
| 6      | C3        | 4      | PTA4                           | XTAL0                 | XTAL0                 | PTA4                           | I2C0_SDA   | I2C0_SCL   | LPUART0_RX | CLKOUT |
| 7      | D3        | 5      | PTA5/<br>RTC_CLK_IN            | 禁用                    |                       | PTA5/<br>RTC_CLK_IN            | TPM0_CH1   | SPI0_SS_b  |            |        |
| 8      | D5        | 6      | PTA6                           | 禁用                    |                       | PTA6                           | TPM0_CH0   | SPI0_MISO  |            |        |
| 9      | —         | —      | PTB10                          | 禁用                    |                       | PTB10                          | TPM0_CH1   | SPI0_SS_b  |            |        |
| 10     | —         | —      | PTB11                          | 禁用                    |                       | PTB11                          | TPM0_CH0   | SPI0_MISO  |            |        |
| 11     | D4        | 7      | PTA7/<br>IRQ_4                 | 禁用                    |                       | PTA7/<br>IRQ_4                 | SPI0_MISO  | SPI0_MOSI  |            |        |
| 12     | C1        | 8      | PTB0/<br>IRQ_5/<br>LLWU_P4     | ADC0_SE9              | ADC0_SE9              | PTB0/<br>IRQ_5/<br>LLWU_P4     | EXTRG_IN   | SPI0_SCK   | I2C0_SCL   |        |
| 13     | D1        | 9      | PTB1/<br>IRQ_6                 | ADC0_SE8/<br>CMP0_IN3 | ADC0_SE8/<br>CMP0_IN3 | PTB1/<br>IRQ_6                 | LPUART0_TX | LPUART0_RX | I2C0_SDA   |        |
| 14     | B1        | 10     | PTB2/<br>IRQ_7                 | VREF_OUT/<br>CMP0_IN5 | VREF_OUT/<br>CMP0_IN5 | PTB2/<br>IRQ_7                 | LPUART0_RX | LPUART0_TX |            |        |
| 15     | D2        | —      | PTA8                           | ADC0_SE3              | ADC0_SE3              | PTA8                           | I2C0_SCL   | SPI0_MOSI  |            |        |
| 16     | C2        | —      | PTA9                           | ADC0_SE2              | ADC0_SE2              | PTA9                           | I2C0_SDA   | SPI0_SCK   |            |        |
| 17     | A1        | 11     | PTB3/<br>IRQ_10                | 禁用                    |                       | PTB3/<br>IRQ_10                | I2C0_SCL   | LPUART0_TX |            |        |

| 24 QFN | 20 WLC SP | 16 QFN | Pin Name                         | 默认值                   | ALT0                   | ALT1                             | ALT2       | ALT3       | ALT4 | ALT5   |
|--------|-----------|--------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------|------|--------|
| 18     | B2        | 12     | PTB4/<br>IRQ_11                  | 禁用                    |                        | PTB4/<br>IRQ_11                  | I2C0_SDA   | LPUART0_RX |      |        |
| 19     | A2        | 13     | PTB5/<br>IRQ_12                  | NMI_b                 | ADC0_SE1/<br>CMP0_IN1  | PTB5/<br>IRQ_12                  | TPM1_CH1   | NMI_b      |      |        |
| 20     | B3        | —      | PTA12/<br>IRQ_13/<br>LPTMR0_ALT2 | ADC0_SE0/<br>CMP0_IN0 | ADC0_SE0/<br>CMP0_IN0  | PTA12/<br>IRQ_13/<br>LPTMR0_ALT2 | TPM1_CH0   | TPM_CLKIN0 |      | CLKOUT |
| 21     | A3        | —      | PTB13/<br>CLKOUT32K              | 禁用                    |                        | PTB13/<br>CLKOUT32K              | TPM1_CH1   | RTC_CLKOUT |      |        |
| 22     | A4        | 14     | PTA0/<br>IRQ_0/<br>LLWU_P7       | SWD_CLK               | ADC0_SE15/<br>CMP0_IN2 | PTA0/<br>IRQ_0/<br>LLWU_P7       | TPM1_CH0   | SWD_CLK    |      |        |
| 23     | B4        | 15     | PTA1/<br>IRQ_1/<br>LPTMR0_ALT1   | RESET_b               |                        | PTA1/<br>IRQ_1/<br>LPTMR0_ALT1   | TPM_CLKIN0 | RESET_b    |      |        |
| 24     | A5        | 16     | PTA2                             | SWD_DIO               |                        | PTA2                             | CMP0_OUT   | SWD_DIO    |      |        |

## 5.2 KL03 引脚分配

下图显示的是本档中所支持器件的引脚分配。多个信号可能多路复用至一个引脚。要确定引脚使用的信号，请参见 [KL03 信号多路复用和引脚分配](#)。

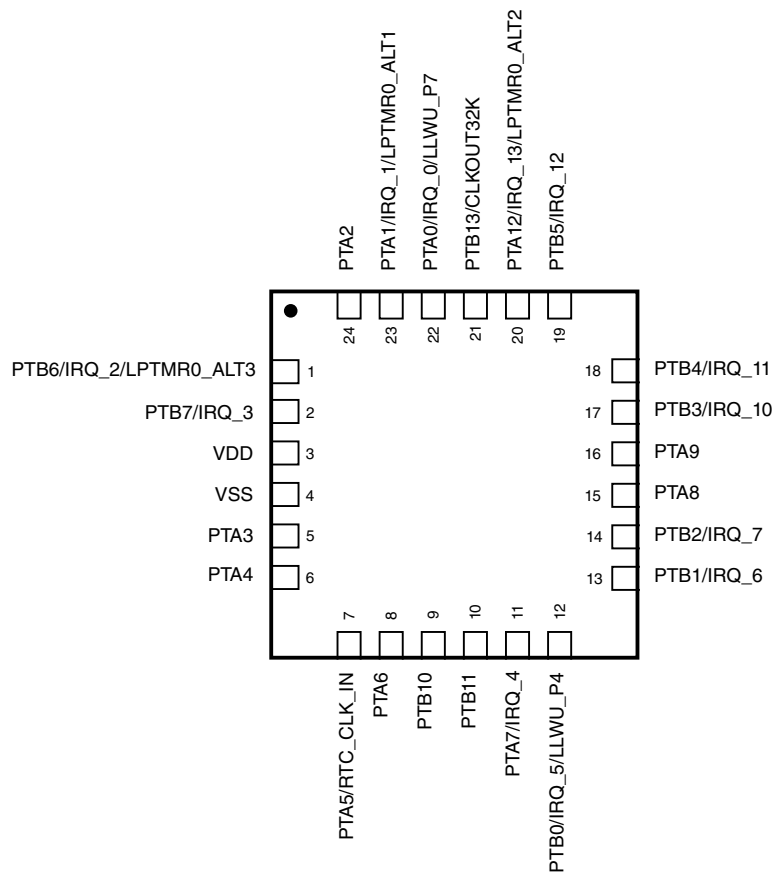


图 17. KL03 24 引脚 QFN 引脚分配图

|   | 1    | 2    | 3     | 4    | 5    |
|---|------|------|-------|------|------|
| A | PTB3 | PTB5 | PTB13 | PTA0 | PTA2 |
| B | PTB2 | PTB4 | PTA12 | PTA1 | VDD  |
| C | PTB0 | PTA9 | PTA4  | PTA3 | VSS  |
| D | PTB1 | PTA8 | PTA5  | PTA7 | PTA6 |

图 18. KL03 20 引脚 WLCSP 引脚分配图

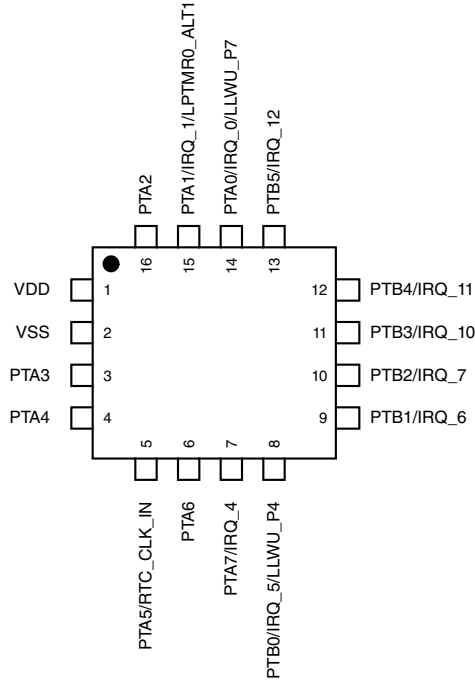


图 19. KL03 16 引脚 QFN 引脚分配图

## 6 订购器件

### 6.1 确定有效的可订购器件

有效的可订购器件型号已发布在网络上。要确定该器件的可订购型号，请访问 [freescale.com](http://freescale.com)，然后对以下器件执行型号搜索：

## 7 部件标识

### 7.1 说明

芯片的器件型号包含识别具体器件的字段。您可以使用这些字段的值来确定收到的具体器件。



## 7.2 格式

该设备的器件编号采用如下格式：

Q KL## A FFF R T PP CC N

## 7.3 字段

下表列出器件型号中每个字段的可能值（并非所有组合都有效）：

表 41. 器件型号字段说明

| 字段   | 说明             | 值   |
|------|----------------|---|
| Q    | 认证状态           | <ul style="list-style-type: none"> <li>M = 完全合格，一般市场流通（WLCSP 整卷）</li> <li>P = 资格预审</li> <li>K = 完全合格，一般市场流通，每卷 100 件（仅限 WLCSP）</li> </ul>                 |
| KL## | Kinetis 系列     | <ul style="list-style-type: none"> <li>KL03</li> </ul>  |
| A    | 主要属性           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Z = Cortex-M0+</li> </ul>  |
| FFF  | 程序存储器大小        | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 = 8 KB</li> <li>16 = 16 KB</li> <li>32 = 32 KB</li> </ul>  |
| R    | 芯片版本           | <ul style="list-style-type: none"> <li>（空白）= 主版本</li> <li>A = 主版本后的修订版本</li> </ul>  |
| T    | 温度范围(°C)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>V = -40 至 105</li> <li>V = -40 至 85</li> </ul>   |
| PP   | 封装标识符          | <ul style="list-style-type: none"> <li>FG = 16 QFN (3 mm x 3 mm)</li> <li>AF = 20 WLCSP (1.99 mm x 1.61 mm)</li> <li>FK = 24 QFN (4 mm x 4 mm)</li> </ul> |
| CC   | 最大 CPU 频率(MHz) | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 = 48 MHz</li> </ul>  |
| N    | 封装类型           | <ul style="list-style-type: none"> <li>R = 盘卷</li> <li>（空）= 托盘</li> </ul>   |

## 7.4 示例

下面是一些器件型号示例：

MKL03Z32VFK4

## 8 术语和准则

### 8.1 定义：操作要求

操作要求是指在操作过程中必须保证达到的技术特性的指定值或值范围，目的是避免错误操作以及缩短芯片使用寿命。

#### 8.1.1 示例

下面是一个操作要求示例：

| 符号              | 说明           | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|--------------|-----|-----|----|
| V <sub>DD</sub> | 1.0 V 内核供电电压 | 0.9 | 1.1 | V  |

### 8.2 定义：特性

除非另有说明，特性是指在操作过程中，只要满足操作要求及其他任何指定条件，即保证达到的技术特性的指定值或值范围。

#### 8.2.1 示例

下面是一个特性示例：

| 符号              | 说明              | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|-----------------|-----|-----|----|
| I <sub>WP</sub> | 数字 I/O 弱上拉/下拉电流 | 10  | 130 | μA |

### 8.3 定义：属性

属性是指无论是否满足操作要求，均可保证达到的技术特性的指定值或值范围。

### 8.3.1 示例

下面是一个属性示例：

| 符号    | 说明        | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|-----------|-----|-----|----|
| CIN_D | 输入电容：数字引脚 | —   | 7   | pF |

## 8.4 定义：极限

极限是指技术特性的最小值或最大值，如果超过此值，可能会导致芯片发生永久性故障：

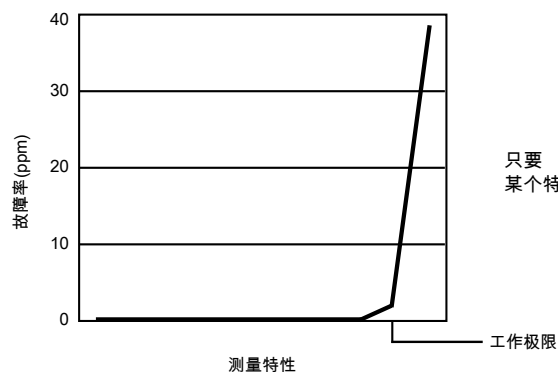
- 运行极限适合在芯片操作过程中使用。
- 非运行极限适合在芯片未通电的情况下使用。

### 8.4.1 示例

下面是一个运行极限示例：

| 符号              | 说明           | 最小值  | 最大值 | 单位 |
|-----------------|--------------|------|-----|----|
| V <sub>DD</sub> | 1.0 V 内核供电电压 | -0.3 | 1.2 | V  |

## 8.5 超出极限的后果



## 8.6 极限与操作要求的关系



## 8.7 极限和操作要求准则

在应用极限和操作要求时，请遵循以下准则：

- 切勿超出芯片的任何一个极限。
- 在正常操作期间，不要超出芯片的任何一项操作要求。
- 如果在非正常操作期间必须要超出某项操作要求（例如在上电时序期间），请尽量缩短持续时间。

## 8.8 定义：典型值

典型值是指满足下列条件的技术特性的指定值：

- 在特性指定的值范围内
- 在典型的制造工艺流程中，只要满足典型值条件或其他指定条件，即在操作过程中代表该特性

典型值供设计指导之用，未测试和担保。

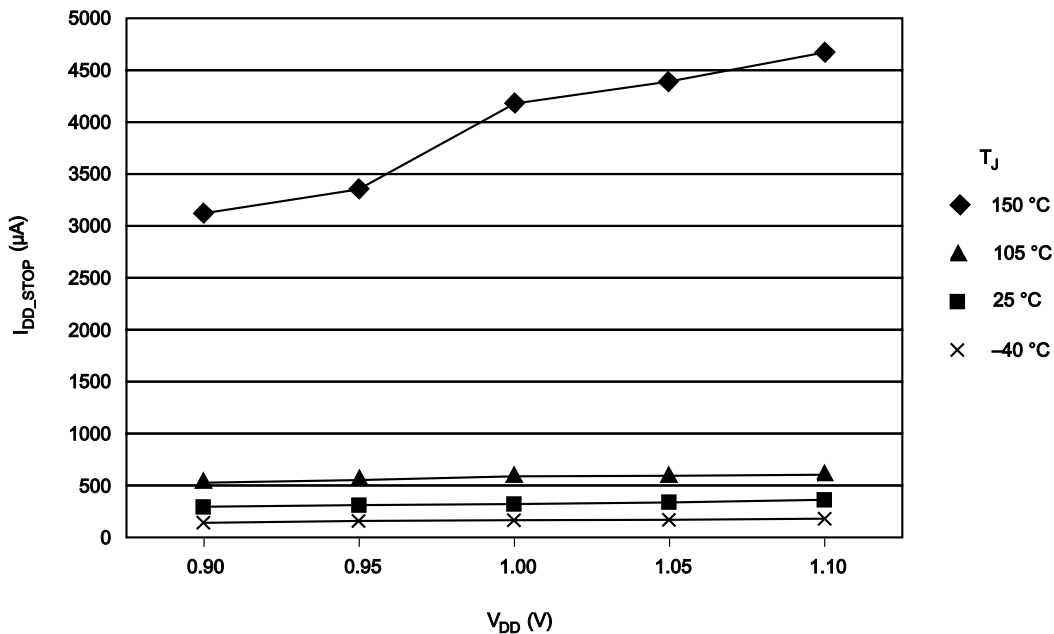
### 8.8.1 示例 1

下面是一个包含典型值的特性示例:

| 符号       | 说明              | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位            |
|----------|-----------------|-----|-----|-----|---------------|
| $I_{WP}$ | 数字 I/O 弱上拉/下拉电流 | 10  | 70  | 130 | $\mu\text{A}$ |

### 8.8.2 示例 2

下面是一个显示不同电压和温度条件下的典型值的图表示例:



## 8.9 典型值条件

典型值假设满足下列条件 (或指定的其他条件):

表 42. 典型值条件

| 符号       | 说明         | 值   | 单位                 |
|----------|------------|-----|--------------------|
| $T_A$    | 环境温度       | 25  | $^{\circ}\text{C}$ |
| $V_{DD}$ | 3.3 V 供电电压 | 3.3 | V                  |

## 9 修订记录

下表列出本文的修订记录。

**表 43. 修订记录**

| 修订版本号 | 日期      | 重大变更  |
|-------|---------|---|
| 3.1   | 07/2014 | 初次公开发行版。  |
| 4     | 08/2014 | 将引脚分配信号名称 ADC0_SE5、ADC0_SE6 和 ADC0_SE12 分别改为 ADC0_SE8、ADC0_SE9 和 ADC0_SE15。 |

**How to Reach Us:**

**Home Page:**

[freescale.com](http://freescale.com)

**Web Support:**

[freescale.com/support](http://freescale.com/support)

本文档中的信息仅供系统和软件实施方使用 Freescale 产品。本文并未明示或暗示授予利用本文档信息进行设计或者加工集成电路的版权许可。Freescale 保留对本文档中所述任何产品进行更改的权利，恕不另行通知。

Freescale 对其产品在任何特定用途方面的适用性不做任何担保、表示或保证，也不承担因为应用或使用产品或电路所产生的任何责任，明确拒绝承担包括但不限于因果性或附带损害在内的所有责任。Freescale 的数据表和/或规格中所提供的“典型”参数在不同应用中可能并且确实不同，实际性能会随时间而有所变化。所有操作参数，包括“典型值”在内，在每个客户应用中必须经由技术专家进行验证。Freescale 未转让与其专利权及其他权利相关的许可。Freescale 销售产品时遵循以下网址中包含的标准销售条款和条件：[freescale.com/SalesTermsandConditions](http://freescale.com/SalesTermsandConditions)。

飞思卡尔(Freescale)、飞思卡尔徽标、节能解决方案徽标和 Kinetis 是飞思卡尔半导体有限公司(Freescale Semiconductor, Inc.) 在美国专利和商标局注册的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。ARM 和 Cortex 是 ARM 有限公司（或其子公司）在欧盟和/或其他地方注册的商标。保留所有权利。

©2014 Freescale Semiconductor, Inc.